智慧財產及商業法院行政判決

111年度行專訴字第15號

民國111年8月3日辯論終結

原　　告　日商迪愛生股份有限公司

代　表　人　猪野 薫

訴訟代理人　桂齊恒律師

複 代理 人　何娜瑩律師

訴訟代理人　江郁仁律師

　　簡偉倫專利師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏

訴訟代理人　韓薰蘭

參　加　人　德商馬克專利公司

代　表　人　Sabine Schoen

　　Martin Schmidt

訴訟代理人　張哲倫律師

　　戴雅芠律師

　　李協書專利師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國111年1月5日經訴字第11006307400號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主　　文

訴願決定及原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」部分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國102年3月26日以「液晶組成物及使用其之液晶顯示元件」向被告申請發明專利，經被告編為第102110578號審查，准予專利，並發給發明第I488948號專利證書（下

稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第26條第1項、第2項及第22條第2項之規定，對之提起舉發。原告多次提出系爭專利申請專利範圍更正本（最後一次為109年8月3日），案經被告審查，認系爭專利109年8月3日之更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1至9違反核准時專利法第22條第2項之規定，以110年6月11日（110）智專三（五）01058字第11020556080號專利舉發審定書為「109年8月3日之更正事項，准予更正」、「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。原告不服，就原處分有關舉發成立之部分向經濟部提起訴願，亦經經濟部作成訴願駁回之決定（下稱訴願決定）。原告仍不服，向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定，應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告起訴主張略以：

參加人前於107年10月3日以附表所示之證據7至13為引證，舉發系爭專利更正後之請求項1至9違反核准時專利法第22條第2項之規定，而請求撤銷系爭專利請求項1至9。惟查，系爭專利核准公告之申請專利範圍共計9項，經原告於109年8月3日向被告申請更正，被告於110年6月11日准予更正並公告，系爭專利更正後之請求項共計9項，其中第1至5項與第8至9項為獨立項，其餘為附屬項。在系爭專利申請時，已知使用具有烯基化合物時會引起組成物氧化產生之雜質，因而引起VHR降低或殘像，為抑制由液晶組成物之氧化引起之劣化，故避免添加具有環己烯基作為環結構之化合物。準此，系爭專利所要解決之課題在於提供一種液晶組成物及使用其之液晶顯示元件，該液晶組成物係不使介電異向性、黏度、向列相上限溫度、於低溫之向列相穩定性、旋轉黏度(γ1)等作為液晶顯示元件之各特性及顯示元件之殘像特性變差，製造時難以產生滴加痕，且於ODF步驟中實現穩定之液晶材料之噴出量的適於液晶顯示元件者。因此，系爭專利藉由添

加如系爭專利之通式(I)所示之具烯基之化合物（參原告行政訴訟補充理由狀㈠第2頁即本院卷二第24頁，該圖紅色標示處為烯基鍵），且以特定混合比例使用特定之液晶化合物，並排除該圖所示具有環己烯基環之化合物，可抑制液晶顯示元件中產生滴加痕之缺點並抑制由液晶組成物之氧化引起之劣化。藉由系爭專利具有特定混合比例、特定液晶化合物形成之液晶組成物，系爭專利之液晶顯示元件具有高速應答性優異、殘像之產生較少之特徵，且因製造過程引起之滴加痕之產生能明顯減少等優點。故系爭專利符合專利法第22條第2項之進步性，並無被告及參加人如後所述之不具進步性問題，參加人於舉發時所提出之如附表所示引證均不足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性，是以，原處分及訴願決定均非適法，爰聲明請求判決：「原處分關於請求項1至9舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷。

三、被告答辯略以：

本案109年8月3日更正本係更正申請專利範圍請求項1至6、8及9之內容，屬申請專利範圍之縮減，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，是本案依據109年8月3日更正本審查。證據7已揭示系爭專利請求項2之組成結構及含量，可預期二者功效相同，且二者均為液晶組合物之相關技術領域，系爭專利又未具有無法預期的功效，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據7揭示之液晶化合物中所含各組分化合物及其比例範圍，應可輕易完成系爭專利請求項2之液晶組成物。故證據7足以證明系爭專利請求項1、2、4至7不具進步性；證據11足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性；證據12足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性；證據7或12及證據8至11（擇一）之組合足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性；證據7及證據8至12（擇一）之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性；證據13及證據7至12（擇一）之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性；證據13及證據7至10（擇一）之組合足以證明系爭專利請求

項9不具進步性等情，故系爭專利請求項1至9違反核准時專利法第22條第2項之規定，原告主張為無理由，爰答辯聲明：原告之訴駁回。

四、參加人陳述意見略以：

系爭專利請求項1、4之通式（Ⅱ）之比例實屬發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易調配完成者。又即使液晶組成物中，通式（Ⅱ）化合物之含量高達11%（例如實施例12），該組成物依舊展現所稱優異之滴加痕評價結果。因此，原告將通式（Ⅱ）化合物之含量更正限縮至更正後請求項1中所載之「3-9.5質量%」，並未使整體組成物之滴加痕表現產生任何差異。亦即，此含量差異對所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅是先前技術之簡單變更，並未產生任何無法預期之技術效果（系爭專利說明書之實例3至6及8至11所示）。而揭示式Ⅶ化合物之含量差異對所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅是基於證據12內容之簡單變更，實為所屬技術領域中具有通常知識者經由有限實驗可輕易調配完成者。系爭專利說明書中並未提供任何實例說明具有特定含量範圍之式（Ⅵ-a3）及式（Ⅵ-a4）化合物可產生任何特殊功效，其通篇揭示之內容顯示該等含量範圍不具任何無法預期之功效。系爭專利請求項1至7顯然為所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據7至12之任一者或其組合所能輕易完成，故系爭專利請求項1至7不具進步性。且證據7至12或其組合已揭露系爭專利請求項1至7之液晶組成物之全部組成及含量，在組成相同之情形下，其所展現之功效特性亦會相同，故所屬技術領域中具有通常知識者依證據7至12或其組合揭示之內容，或再經由有限之實驗簡單調整含量，即可輕易完成系爭專利請求項1至7之液晶組成物，達成系爭專利相同之功效。根據系爭專利說明書本身之內容，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者完全無法得知液晶組成物中「式（Ⅰ）化合物、式（Ⅱ）化合物、式（Ⅲb-1）化合物」及「式（Ⅲa）化合物及式（Ⅳ）化合物」具有「特定成分之

組合所致之相互作用」，遑論藉由任何追加實驗數據以證明該功效。再者，液晶組成物中化合物間之「相互作用」至關重要，然而系爭專利所載實施例中並無提及「相互作用」，是原告於申請時應將化合物間「相互作用」之具體內容記載於說明書中，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，經參酌系爭專利說明書，至多可推知通式（Ⅰ）、通式（Ⅱ）及通式（Ⅲb-1）化合物為液晶組成物之必要成分，無法使通常知識者知悉相互作用及預期之效果。又系爭專利請求項9所請為一種液晶顯示器，其包含如系爭專利請求項8之液晶顯示元件，其中該液晶顯示元件進一步包含「配向膜」。查證據7至10業已提供包含「配向膜」之液晶顯示元件，證據9、10包含反向交錯型薄膜電晶體及配向膜之液晶顯示元件，實屬系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，得經由參酌證據13與「證據7至10中任一者」之組合之揭示，可輕易推知並完成者。是以，系爭專利請求項9相較於證據13與「證據7至10中任一者」之組合不具進步性。原處分及訴願決定均無不合，爰聲明請求如答辯聲明。

五、本件爭點（本院卷二第120至121頁）：

㈠、證據7是否足以證明系爭專利請求項1至2、4至7不具進步性？

㈡、證據8是否足以證明系爭專利請求項1、3、6不具進步性？

㈢、證據9是否足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性？

㈣、證據10是否足以證明系爭專利請求項1至4、6至7不具進步性？

㈤、證據11是否足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性？

㈥、證據12是否足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性？

㈦、證據7或12及證據8至11（擇一）之組合是否足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性？

㈧、證據7及證據8至12（擇一）之組合是否足以證明系爭專利請求項3不具進步性？

㈨、證據7至12（擇一）及證據13之組合是否足以證明系爭專利請求項8不具進步性？

㈩、證據7至10（擇一）及證據13之組合是否足以證明系爭專利請求項9不具進步性？

六、本院之判斷：

㈠、應適用之法律：

按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定」，專利法第71條第3 項本文定有明文。查系爭專利於102年3月26日申請，經被告審查後於104年6月21日准予專利等情，是系爭專利是否不具進步性，應以核准審定時專利法即103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專利法為斷（下稱核准時專利法）。次按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為核准時專利法第21條及第22條第1項前段所明定。又發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得取得專利，復為同法第22條第2 項所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反核准時專利法第22條第2項之規定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。

㈡、系爭專利技術分析：

１、系爭專利技術內容：

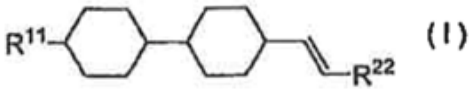
提供一種液晶組成物及使用其之液晶顯示元件，該液晶組成物係不使介電異向性、黏度、向列相上限溫度、於低溫之向列相穩定性、γ1等作為液晶顯示元件之各特性及顯示元件之殘像特性變差，製造時難以產生滴加痕，且於ODF步驟中實現穩定之液晶材料之噴出量的適於液晶顯示元件者(參系爭專利摘要）。

２、系爭專利申請專利範圍分析：

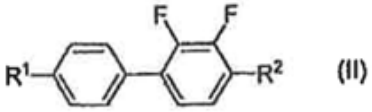
系爭專利核准公告之申請專利範圍共計9項，經原告於109年8月3日向被告申請更正，被告於110年6月11日准予更正並公

告，系爭專利更正後之請求項共計9項，其中第1至5項及第8至9項為獨立項，其餘為附屬項，該等請求項之內容如下：

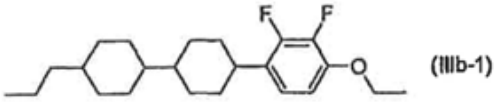
⑴、請求項1：一種液晶組成物，其介電異向性為負，其特徵在於：含有2～25質量%之選自通式（I）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，含有3～9.5質量%之選自通式（II）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，且含有5～25質量%之式（IIIb-1）所表示之化合物，含有通式（IIIa）所表示之化合物1種或2種以上，含有通式（IV）所表示之化合物1種或2種以上，並且不含有具有環己烯基（cyclohexenylene）環之化合物，

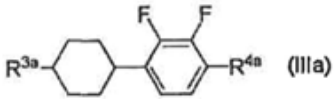


（式中，R11表示碳原子數1～3之烷基，R22表示碳原子數1～3之烷基或氫原子）

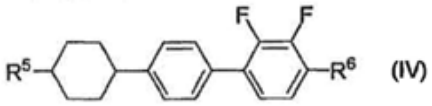


（式中，R1為碳原子數1～8之烷基、R2表示碳原子數1～8之烷氧基）





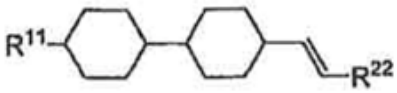
（式中，R3a及R4a分別獨立表示碳原子數1～8之烷基或碳原子數1～8之烷氧基）



（式中，R5及R6分別獨立表示碳原子數1～8之烷基或碳原子數1～8之烷氧基）。

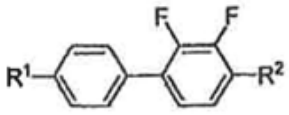
⑵、請求項2：一種液晶組成物，其介電異向性為負，其特徵在於：含有2～25質量%之選自通式（I）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，含有3～25質量%之選自通式（I

I）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，且含有5～25質量%之式（IIIb-1）所表示之化合物，含有選自式（IIIa-1）～式（IIIa-8）所表示之化合物群中之化合物1種或2種以上，含有選自式（IV-1）～（IV-4）所表示之化合物群中之化合物1種或2種以上，含有選自式（VI-a）～（VI-e）所表示之化合物群中1種～5種之化合物，上述選自式（VI-a）～（VI-e）所表示之化合物群中之化合物其含量的合計為30～40質量%，並含有式（VI-c5）所表示之化合物作為上述選自式（VI-a）～（VI-e）所表示之化合物群中之化合物，並且介電異向性△ε於25℃時為-2.0～-6.0，折射率異向性△n於25℃時為0.08～0.13，並且不含有具有環己烯基環之化合物，



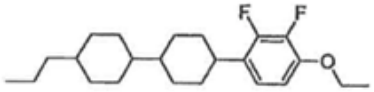
(I)

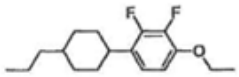
（式中，R11表示碳原子數1～3之烷基，R22表示碳原子數1～3之烷基或氫原子）

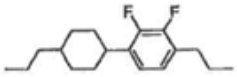


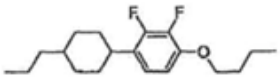
(II)

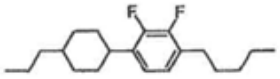
（式中，R1為碳原子數1～8之烷基、R2表示碳原子數1～8之烷氧基）

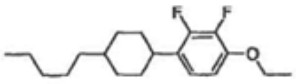

(IIIb-1)

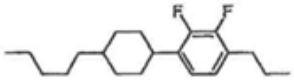

(IIIa-1)

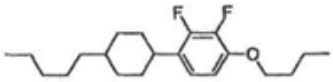

(IIIa-5)

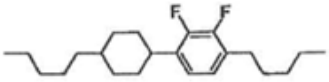

(IIIa-2)

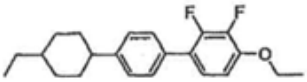

(IIIa-6)

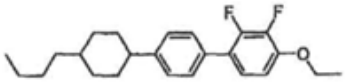

(IIIa-3)

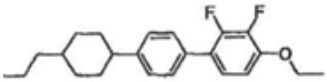

(IIIa-

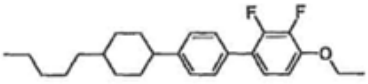

(IIIa-4)

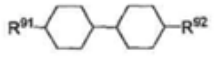

(IIIa-8

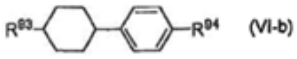

(IV-1)

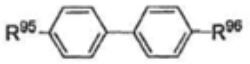

(IV-3)

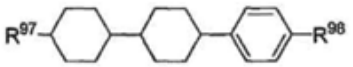

(IV-2)


(IV-4)


(VI-a)


(VI-b)


(VI-c)


(VI-d)

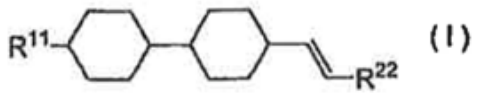

(VI-e)

（R91及R92分別獨立表示碳原子數1至10之烷基或碳原子數1至10之烷氧基，R93至R9a分別獨立表示碳原子數1至10之烷基、碳原子數1至10之烷氧基或碳原子數2至10之烯基）。

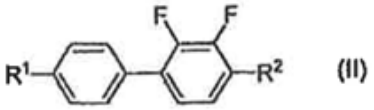

(VI-c5)

⑶、請求項3：一種液晶組成物，其介電異向性為負，其特徵在於：含有2～25質量%之選自通式（I）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，含有3～25質量%之選自通式（II）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，且含有5～25質量%之式（IIIb-1）所表示之化合物，含有通式（IV）所表示之化合物1種或2種以上，進而含有1種或2種以上之選自通式（III）所表示之化合物群中之化合物，並含有1

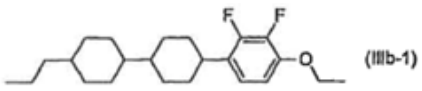
種或2種以上之通式（IIIa）所表示之化合物來作為上述通式（III）所表示之化合物，並進而含有1種或2種以上之選自由式（V-5）所表示之化合物群中之化合物，並且不含有具有環己烯基環之化合物，

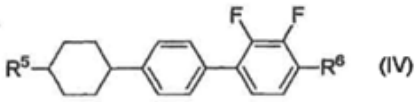


（式中，R11表示碳原子數1～3之烷基，R22表示碳原子數1～3之烷基或氫原子）

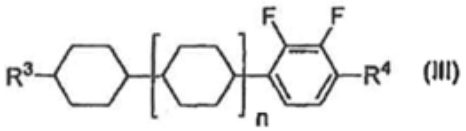


（式中，R1為碳原子數1～8之烷基、R2表示碳原子數1～8之烷氧基）

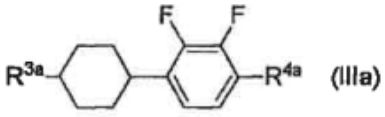




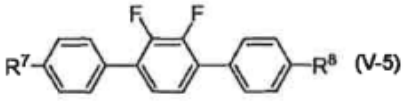
（式中，R5及R6分別獨立表示碳原子數1～8之烷基或碳原子數1 ～8之烷氧基）



（式中，R3及R4分別獨立表示碳原子數1～8之烷基或碳原子數1～8之烷氧基，n表示0或1，但不包括R3為碳原子數3之烷基、R4為碳原子數2之烷氧基且n表示1之化合物）

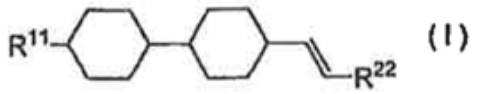


（式中，R3a及R4a分別獨立表示碳原子數1～8之烷基或碳原子數1～8之烷氧基）



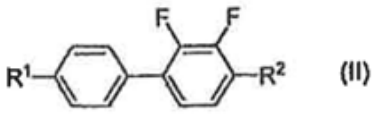
（式中，R7及R8分別獨立表示碳原子數1～8 之烷基、碳原子數2～8之烯基、碳原子數1～8之烷氧基或碳原子數2～8之烯氧基，該烷基、烯基、烷氧基及/或烯氧基中之1個以上之氫原子可被取代為氟原子，該烷基、烯基、烷氧基及/或烯氧基中之亞甲基只要氧原子不連續地鍵結則可被取代為氧原子，只要羰基不連續地鍵結則可被取代為羰基）。

⑷、請求項4：一種液晶組成物，其介電異向性為負，其特徵在於：含有2～25質量%之選自通式（I）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，含有3～9.5質量%之選自通式（II）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，且含有5～25質量%之式（IIIb-1）所表示之化合物，含有1種或2種以上之通式（III）所表示之化合物，並含有1種或2種以上之通式（IIIa）所表示之化合物來作為上述通式（III）所表示之化合物，進而含有1種或2種以上之選自通式（IV）所表示之化合物群中之化合物，必要成分即通式（I）、通式（II）、式（IIIb-1）、通式（III）及通式（IV）所表示之化合物、與任意成分即通式（V）及通式（VI-a）～通式（VI-e）所表示之化合物之合計含量為95質量%以上且100質量%以下，並且不含有具有環己烯基環之化合物，



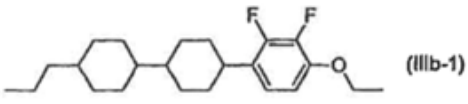
(I)

（式中，R11表示碳原子數1～3之烷基，R22表示碳原子數1～3之烷基或氫原子）

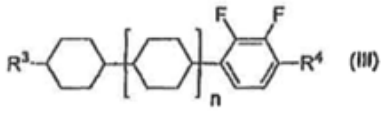


(II)

（式中，R1為碳原子數1～8之烷基、R2表示碳原子數1～8之烷氧基）

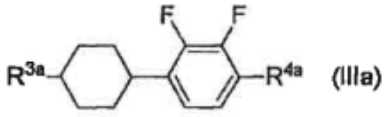


(IIIb-1)

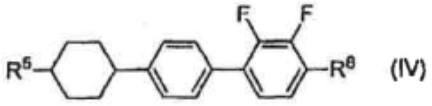


(III)

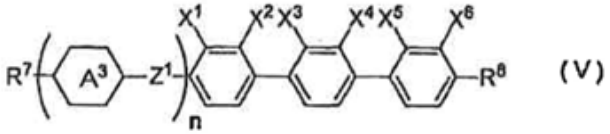
（式中，R3及R4分別獨立表示碳原子數1～8之烷基或碳原子數1～8之烷氧基，n表示0或1，但不包括R3為碳原子數3之烷基、R4為碳原子數2之烷氧基且n表示1之化合物）



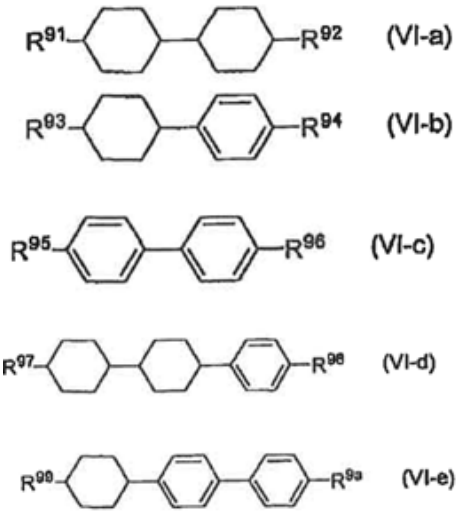
（式中，R3a及R4a分別獨立表示碳原子數1～8之烷基或碳原子數1～8之烷氧基）



（式中，R5及R6分別獨立表示碳原子數1～8之烷基或碳原子數1～8之烷氧基）

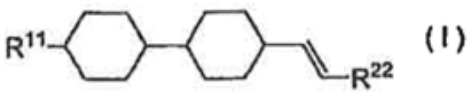


（式中，R7及R8分別獨立表示碳原子數1～8之烷基、碳原子數2～8之烯基、碳原子數1～8之烷氧基或碳原子數2～8之烯氧基，該烷基、烯基、烷氧基及/或烯氧基中之1個以上之氫原子可被取代為氟原子，該烷基、烯基、烷氧基及/或烯氧基中之亞甲基只要氧原子不連續地鍵結則可被取代為氧原子，只要羰基不連續地鍵結則可被取代為羰基，A3表示1,4-伸環己基、1,4-伸苯基或四氫吡喃-2,5-二基，於A3表示1,4-伸苯基之情形時，該1,4-伸苯基中之1個以上之氫原子可被取代為氟原子，Z1表示單鍵、-OCH2-、-OCF2-、-CH2O-或-CF2O-，n表示0或1，X1～X6分別獨立表示氫原子或氟原子，但X1～X6中之至少1個表示氟原子）

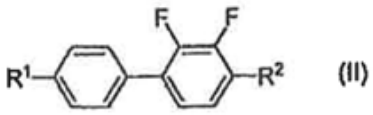


（式中，R91至R9a分別獨立表示碳原子數1至10之烷基、碳原子數1至10之烷氧基或碳原子數2至10之烯基，但通式（VI-a）所表示之化合物中，不包括R91表示碳原子數1～3之烷基、R92表示碳原子數1～5之1-烯烴基或氫原子之化合物）。

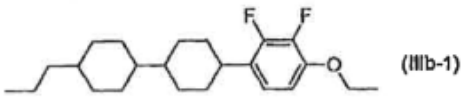
⑸、請求項5：一種液晶組成物，其介電異向性為負，其特徵在於：含有2～25質量%之選自通式（I）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，含有3～25質量%之選自通式（II）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物，且含有5～25質量%之式（IIIb-1）所表示之化合物，含有選自式（IIIa-1）～式（IIIa-8）所表示之化合物群中之化合物1種或2種以上，含有選自式（IV-1）～（IV-4）所表示之化合物群中之化合物1種或2種以上，進而含有式（VI-a5）所表示之化合物，進而含有15～30質量%之式（VI-a3）所表示之化合物，進而含有1～6質量%之式（VI-a4）所表示之化合物，並含有選自下述式（I-1）、式（I-2）及式（I-3）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物作為上述通式（I）所表示之化合物，並且不含有具有環己烯基環之化合物，

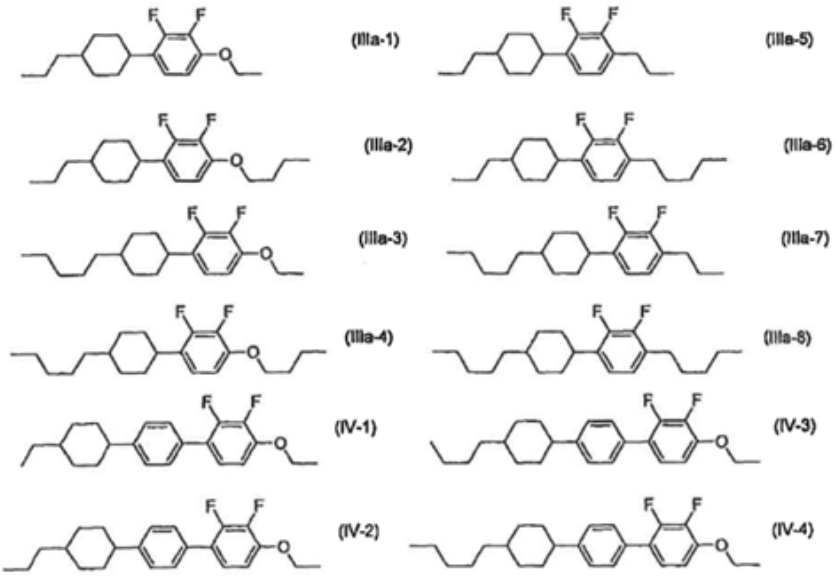


（式中，R11表示碳原子數1～3之烷基，R22表示碳原子數1～3之烷基或氫原子）

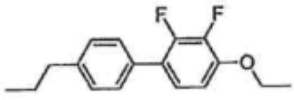


（式中，R1為碳原子數1～8之烷基、R2表示碳原子數1～8之烷氧基）。





⑹、請求項6：如申請專利範圍第1或2項之液晶組成物，其含有式（II-1）所表示之化合物作為通式（II）所表示之化合物，且於150℃、1小時之高溫放置後之電壓保持率（VHR）為99.2%以上，



(II-1)

⑺、請求項7： 如申請專利範圍第1或2項之液晶組成物，其進而含有反應性單體。

⑻、請求項8：一種液晶顯示元件，其使用有申請專利範圍第1至7項中任一項之液晶組成物，並具有反向交錯型薄膜電晶體。

⑼、請求項9：一種液晶顯示器，其使用有具備配向膜之申請專利範圍第8項之液晶顯示元件。

㈢、舉發證據技術分析：

１、證據7：

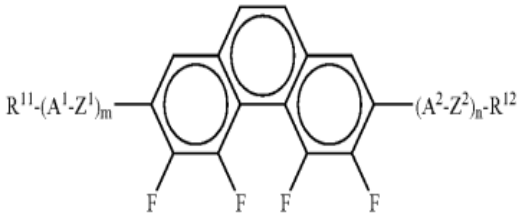
⑴、證據7為西元2013年3月14日公開之美國第2013/0062560A1號「Liquid crystal composition and liquid crystal display device」專利申請案，其公開日期早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

⑵、技術內容：證據7揭示一種具有負介電各向異性的液晶組合物包含作為第一成分的具有大的光學各向異性和負的大介電各向異性的二環化合物，作為第二成分的具有大的最高溫度和大介電各向異性的三環化合物，三環化合物具有大的光學各向異性和大的介電各向異性的第三組分，以及具有小粘度的二環化合物作為第四組分。前述組合物可應用於液晶顯示裝置(乙證1卷第270頁，證據7之摘要）。

２、證據8：

⑴、證據8為西元2008年8月14日公開之美國第2008/0193681A1號「Liquid-Crystal Medium」專利申請案，其公開日期早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

⑵、技術內容：證據8揭示一種基於極性化合物的混合物的液晶介質，其包含至少一種式(I)的化合物，

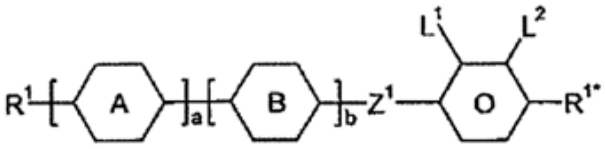


其中R11、R12、A1、A2、Z1、Z2、m和n具有在權利要求1中所示的含義，本發明還涉及所述液晶介質用於基於ECB、PALC或IPS效應的有源矩陣顯示器的用途(乙證1卷第259頁，證據8之摘要）。

３、證據9：

⑴、證據9為西元2012年11月16日公開之我國第201245426A1號「液晶介質」專利申請案，其公開日期早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

⑵、技術內容：證據9揭示一種液晶介質，其包含至少一種如式I之化合物，



其中R1、R1*、環A及B、Z1 、L1、L2、a及b具有技術方案1中所指出之含義，及關於其等於主動矩陣顯示器，特定言之，基於VA、PSA、PS-VA、PALC、FFS、PS-FFS、IPS或PS-IPS效應之主動矩陣顯示器之用途(乙證1卷第244頁，證據9之摘要）。

４、證據10：

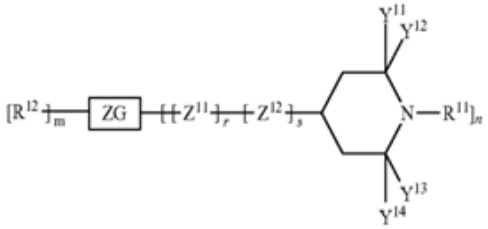
⑴、證據10為西元2012年10月25日公開之美國2012/0268706A1號「Compounds and liquid-crystalline medium」專利申請案，其公開日期早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

⑵、技術內容：證據10揭示一種式I的化合物，並且涉及優選具有向列相和負介電各向异性的液晶介質，其包含：a)一種或

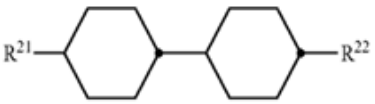
多種式I的化合物和b)一種或多種式II的化合物和/或c)一種或多種選自式III-1至III-4的化合物的化合物，該等化合物，涉及其在電光學顯示器，特別是在基於VA、ECB、PALC、FFS或IPS效應的有源矩陣顯示器中的應用，涉及包含這類液晶介質的這類顯示器，並且涉及式I化合物用於穩定液晶介質的應用，所述液晶介質包含一種或多種式II的化合物和一種或多種選自式III-1至III-4的化合物（乙證1卷第143頁，證據10之摘要）。

⑶、主要圖式：

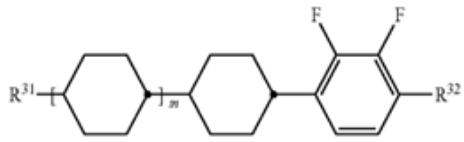
I



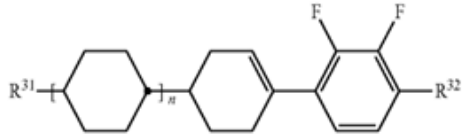
II



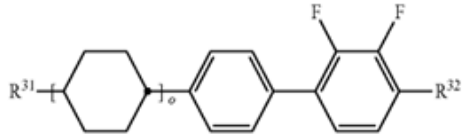
III-1



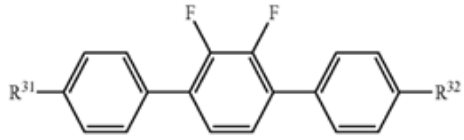
III-2



III-3



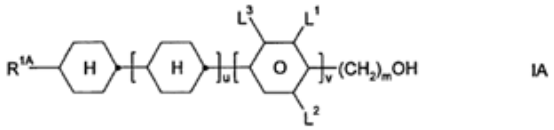
III-4

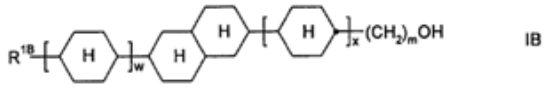


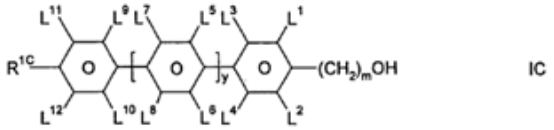
5、證據11：

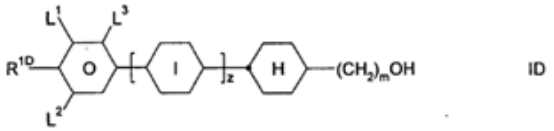
⑴、證據11為西元2013年3月16日公開之我國第201311870A1號「液晶介質」專利申請案，其公開日期早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

⑵、技術內容：證據11揭示一種液晶介質，其係基於具有負介電各向異性之極性化合物之混合物且含有至少一種自配向添加劑，尤其至少一種選自式IA至ID化合物之群的添加劑，


IA


IB


IC

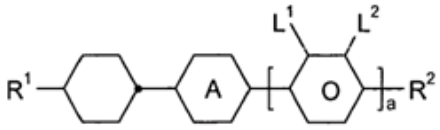

ID

其中R1A、R1B、R1C、L1-12、R1D、環I、u、v、w、x、y、z及m具有技術方案4中所指出之含義；且係關於其用於LC顯示器中之尤其基於VA、PSA及PS-VA效應之主動矩陣顯示器的用途(乙證1卷第115頁及該頁背面，證據11之摘要）。

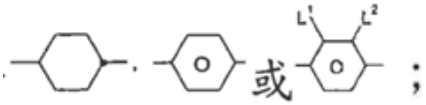
6、證據12：

⑴、證據12為西元2008年2月20日公開之歐洲第1889894A1「Liquid crystalline medium」號專利申請案，其公開日期早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

⑵、技術內容：證據12揭示一種液晶介質(A)包含一種或多種可聚合化合物和一種或多種苯基-環己烷化合物(I)。該液晶介質(A)並可包含一種或多種可聚合化合物和一種或多種式(I)的雜環化合物，


I

環A表示


；

其中a為0或1，L1、L2表示H、F或Cl，R1各自獨立地表示-(CH2)m-CH=CH-CnH2n+1，R2表示C1-12烷基，其中除最後一個-CH=CH2基團外之一或多個CH2基團可被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-或-COO-取代，其中各O原子間不直接相連，且當a=0、環A為環己烷基時，R2亦可為R1；m表示0、1、2、3、4或5；及n表示1、2、3、4、5或6，其中n+m≦6（乙證1卷第21頁背面，證據12之摘要）。

７、證據13：

⑴、證據13為西元1994年5月10日公告之美國第5311041號「Thin film transistor having an inverted stagger type structure」專利，其公告日期早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

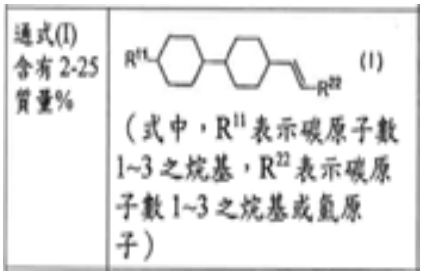
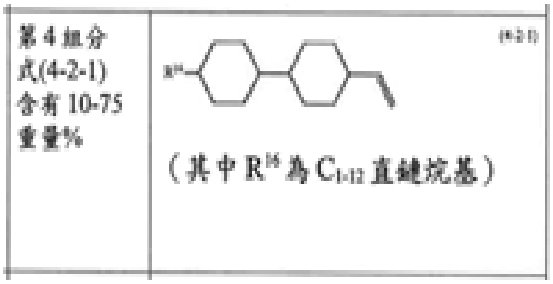
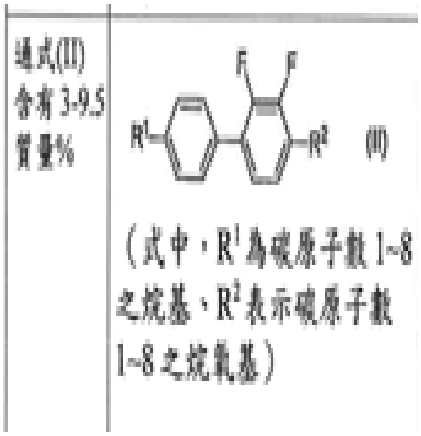
⑵、技術內容：證據13揭示一種反向交錯型結構之薄膜電晶體（TFT），及製造該電晶體之方法。該電晶體係用於作為例如主動式矩陣液晶顯示器之開關裝置，該電晶體包含作為主動層之多晶半導體(乙證3卷第48頁，證據13之摘要）。

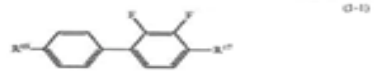
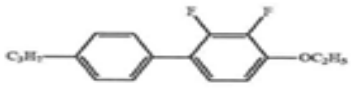
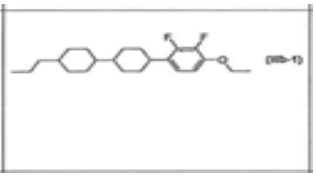
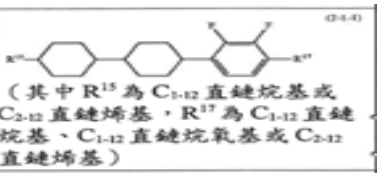
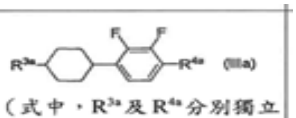
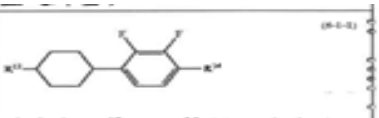
㈣、證據7不足以證明系爭專利請求項1至2、4至7不具進步性：

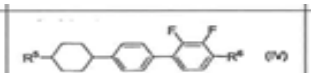
１、證據7不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

⑴、系爭專利請求項1與證據7相較，證據7說明書段落【0001】、【0012】（第12至16行）、【0013】至【0018】、通式第(1)至(4)（中譯文見本院卷二第125至127頁），揭露一種液晶組合物及使用該組合物之液晶顯示裝置，該組合物可具有光學異向性、高負介電異向性、熱穩定性高等性質，且可包含10~75重量%之至少一種選自通式(1)所示化合物的第一組分化合物、10~75重量%之至少一種選自通式(2)所示化合物的第二組分化合物、5~70重量%之至少一種選自通式(3)所示化合物的第三組分化合物、10~75重量%之至少一種選自通式(4)所示化合物的第四組分化合物等成分，證據7說明書段落【0018】、【0047】至【0048】（中譯文見本院卷二第127頁、第133頁）並揭露該液晶組成物包含上述通式(1)至(4)及各組分化合物較佳具體實施例態樣之通式（4-2-

1)、(1-1)、(2-1-1)、(6-1-1)等(下位概念)化合物(乙證1卷第268至270頁背面，證據7第2至5頁)；經查該等化合物可分別對應於系爭專利請求項1所界定之通式(I)、(II)、(IIIb-1)、(IV)、(IIIa)所示者，且符合通式(I)、(IIIb-1)者所界定之含量百分比，證據7與系爭專利請求項1比對結果簡示如下表：

<table>
<tr><td colspan="3">系爭專利請求項1與證據7之比對</td></tr>
<tr><td>技術特徵</td><td>請求項1之記載</td><td>證據7揭示之內容</td></tr>
<tr><td>A</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>比對結果</td><td colspan="2">當該式(4-2-1)化合物含量為10%且R16為碳數1~3之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定R11為碳數1~3之烷基、R22為氫原子</td></tr>
<tr><td>技術特徵</td><td>請求項1之記載</td><td>證據7揭示之內容</td></tr>
<tr><td>B</td><td>
</td><td></td></tr>
</table>

		第1組分式(1-1)含有10-75重量%，實施例1、3、6、8、10揭露通式(1-1)含有3-10重量%  （其中R^{15}為C_{1-12}直鏈烷基或C_{2-12}直鏈烯基，R^{17}為C_{1-12}直鏈烷基、C_{1-12}直鏈烷氧基或C_{2-12}直鏈烯基） Example 1 3-BB(2F,3F)—O2  實施例1包含通式（1-1）所示（3-BB(2F,3F)-O2）化合物總量為10% 實施例3包含通式（1-1）之（3-BB(2F,3F)-O2-（3%） +5-BB(2F,3F)-O2-（4%） ）化合物總量為7% 實施例6包含通式（1-1）之（5-BB(2F,3F)-O2）化合物總量為3% 實施例8包含通式（1-1）之（5-BB(2F,3F)-O2）化合物總量為3% 實施例10包含通式（1-1）之（3-BB(2F,3F)-O2）化合物總量為5%
比對結果	證據7實施例10所揭露5%式(1-1)之3-BB(2F,3F)-O2化合物，符合系爭專利請求項1所界定式(II)化合物中R1為碳數3之烷基、R2為碳數2之烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據7揭示之內容
C	通式(IIIb-1)含有5-25質量% 	第2組分式(2-1-1)含有10-75重量%  （其中R^{15}為C_{1-12}直鏈烷基或C_{2-12}直鏈烯基，R^{17}為C_{1-12}直鏈烷基、C_{1-12}直鏈烷氧基或C_{2-12}直鏈烯基）
比對結果	當該式(2-1-1)化合物含量為10%且R15為碳數3之直鏈烷基、R17為碳數2之直鏈烷氧基時，即符合系爭專利請求項1所界定該式(IIIb-1)化合物	
技術特徵	請求項1之記載	證據7揭示之內容
D	通式(IIIa)  （式中，R^{3a}及R^{4a}分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	第6組分式(6-1-1)  （其中R^{13}和R^{14}獨立地為C_{1-12}烷基、C_{1-12}烷氧基或C_{2-12}烯基）
比對	當該式(6-1-1)化合物的R13、R14獨立地為碳數1~8之烷基	

結果	時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IIIa)化合物中R3a、R4a分別獨立地為碳數1~8之烷基	
技術特徵	請求項1之記載	證據7揭示之內容
E	通式(IV)  （式中，R^5及R^6分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	第3組分式(3-1-1)含有5-70重量%  （其中R^{15}為C_{1-12}直鏈烷基或C_{2-12}直鏈烯基，R^{17}為C_{1-12}直鏈烷基、C_{1-12}直鏈烷氧基或C_{2-12}直鏈烯基）
比對結果	當該式(3-1-1)化合物的R15、R17獨立地為碳數1~8之烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IV)化合物中R5、R6分別獨立地為碳數1~8之烷基	
技術特徵	請求項1之記載	證據7揭示之內容
F	不含有具有環己烯基（cyclohexenylene）環之化合物	未揭示須以具有環己烯基環之化合物為必要成分
比對結果	當證據7之組合物不包含具有環己烯基環之化合物時，即符合系爭專利請求項1所界定者	

⑵、綜上可知，證據7與系爭專利請求項1之差異主要在於證據7未特定揭露如系爭專利請求項1 所界定之成分組合、部分成分含量範圍等，另查熟習該項技術者縱使基於證據7所示異向性、熱穩定度等性質雖有可能嘗試調整證據7所示組合物之成分組成，然由系爭專利說明書實施例、比較例等可知，系爭專利請求項1之發明可同時達成抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，且證據7並未揭示其組合物能同時達成該等功效，尚難謂熟習該項技術者基於證據7所揭示者能完成如系爭專利請求項1之能達成該等功效的組成物，且該組成物之該等功效亦非基於證據7或系爭專利申請日前之通常知識可推論得知的，故亦難謂該等功效係可合理預期的，因此，應認系爭專利請求項1發明

之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，是證據7並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

２、證據7不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

⑴、系爭專利請求項2之技術特徵業如前述，查其與系爭專利請求項1之差異主要在於：(1)式(II)化合物之含量為3~25質量%；(2)式(IIIa)化合物限定於（IIIa-1）～式（IIIa-8）所表示之化合物群；(3)式(IV)化合物限定於（IV-1）～式（IV-4）所表示之化合物群；(4)增列「含有選自式（VI-a）～（VI-e）所表示之化合物群中1種～5種之化合物，上述選自式（VI-a）～（VI-e）所表示之化合物群中之化合物其含量的合計為30～40質量%，並含有式（VI-c5）所表示之化合物作為上述選自式（VI-a）～（VI-e）所表示之化合物群中之化合物，並且介電異向性△ε於25℃時為-2.0～-6.0，折射率異向性△n於25℃時為0.08～0.13」。

⑵、次查，證據7說明書實施例1所揭示3-HB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利請求項2之化合物（IIIa-1）、5-HB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利該請求項之化合物（IIIa-3）；證據7說明書實施例3所揭示3-HBB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利請求項2之化合物（IV-2）、5-HBB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利請求項2之化合物（IV-4）；且證據7提供之液晶組合物實例在25℃下測得之介電向異性值Δε介於-2.8至-3.4（對應系爭專利之介電異向性為負）；在25℃下測得之折射率異向性值Δn介於0.100至0.125。

⑶、綜上，證據7與系爭專利請求項2之差異主要仍在於證據7未特定揭露如系爭專利請求項2所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據7亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是以依前開論述，同前述之理，應認系爭專利請求項2發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據7自不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

３、證據7不足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

⑴、系爭專利請求項4之技術特徵，業如前述，查其與系爭專利請求項1之差異主要在於：(1)關於式(IIIa)化合物調整為「進而含有1種或2種以上之選自通式（III）所表示之化合物群中之化合物，並含有1種或2種以上之通式（IIIa）所表示之化合物來作為上述通式（III）所表示之化合物」；(2)增列「必要成分即通式（I）、通式（II）、式（IIIb-1）、通式（III）及通式（IV）所表示之化合物、與任意成分即通式（V）及通式（VI-a）～通式（VI-e）所表示之化合物之合計含量為95質量%以上且100質量%以下」。

⑵、次查，證據7說明書實施例1所揭示3-HB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利請求項4之式(IIIa)的下位概念化合物（IIIa-1）、5-HB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利請求項4之式(IIIa)的下位概念化合物（IIIa-3）；證據7說明書段落【0018】所揭示化合物如式(5-6)等可對應於系爭專利請求項4通式(V)之化合物(n=0，X4為氟，其餘X皆為氫)；惟證據7並未明確揭露其必要成分與任意成分化合物之合計含量須為95質量%以上且100質量%以下之技術內容。

⑶、綜上，證據7與系爭專利請求項4之差異主要仍在於證據7未特定揭露如系爭專利請求項4所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據7亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，因此，同前述說明，應認系爭專利請求項4發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據7當不足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

４、證據7不足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

⑴、系爭專利請求項5之技術特徵，已如前述；查其與系爭專利請求項1之差異主要在於：(1)關於式(I)化合物增列「並含有選自下述式（I-1）、式（I-2）及式（I-3）所表示之化合物群中之1種或2種以上之化合物作為上述通式（I）所表示之化合物」；(2)關於式(II)化合物之含量調整為3~25質

量%；(3)關於式(IIIa)化合物調整為「含有選自式（IIIa-1）～式（IIIa-8）所表示之化合物群中之化合物1種或2種以上」；(4)關於式(IV)化合物調整為「含有選自式（IV-1）～（IV-4）所表示之化合物群中之化合物1種或2種以上」；(5)增列「進而含有式（VI-a5）所表示之化合物，進而含有15～30質量%之式（VI-a3）所表示之化合物，進而含有1～6質量%之式（VI-a4）所表示之化合物」。

⑵、次查，當證據7所揭示該式(4-2-1)化合物之R16為碳數3的直鏈烷基時，即相當於系爭專利請求項5之化合物（I-1）；證據7說明書實施例1所揭示3-HB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利請求項5之式(IIIa)的下位概念化合物（IIIa-1）、5-HB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利請求項5之式(IIIa)的下位概念化合物（IIIa-3）；證據7說明書實施例3所揭示3-HBB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利請求項5之化合物（IV-2）、5-HBB（2F,3F）-O2即相當於系爭專利請求項5之化合物（IV-4）；證據7說明書實施例5所揭示2-HH-3即相當於系爭專利請求項5之化合物（VI-a3）、實例2、3揭示3-HH-4即相當於系爭專利請求項5之化合物（VI-a4）、實例2、3、4揭示3-HH-5即相當於系爭專利請求項5之化合物（VI-a5）。

⑶、綜上，證據7與系爭專利請求項5之差異主要仍在於證據7未特定揭露如系爭專利請求項5所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據7亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是以依前述說明，應認系爭專利請求項5發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，從而證據7不足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

５、證據7不足以證明系爭專利請求項6至7不具進步性：

⑴、系爭專利請求項6係為依附於系爭專利請求項1或2之附屬項，於解釋系爭專利請求項6之專利權範圍時應包含系爭專利請求項1或2之所有技術特徵。據此，依前開說明，證據7已不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，而系爭專利

請求項6既依附於系爭專利請求項1或2，則證據7當然亦不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

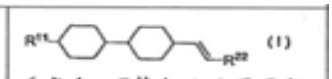
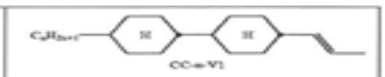
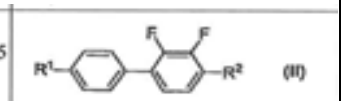
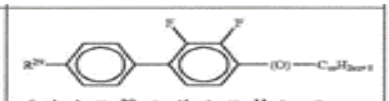
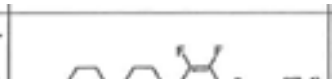
⑵、系爭專利請求項7係為依附於請求項1或2之附屬項，於解釋系爭專利請求項7之專利權範圍時應包含系爭專利請求項1或2之所有技術特徵。據此，依前開說明，證據7已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，而系爭專利請求項7既依附於系爭專利請求項1或2，則證據7當然亦不足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

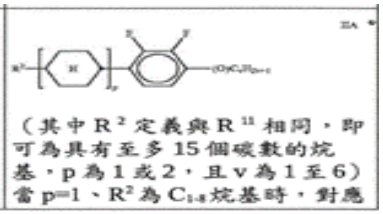
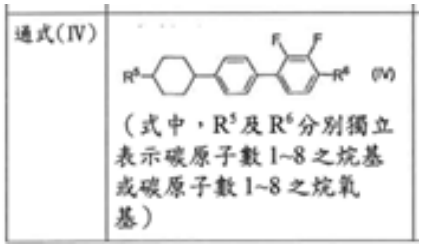
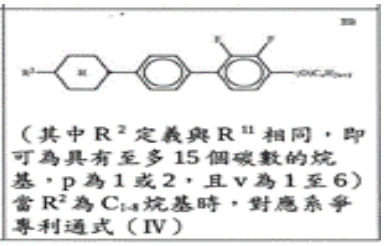
㈤、證據8不足以證明系爭專利請求項1、3、6不具進步性：

１、證據8不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

⑴、系爭專利請求項1之技術特徵，已如前述，而系爭專利請求項1與證據8相較，證據8說明書段落【0001】、【0011】、【0034】至【0042】揭露一種包含式I、IIA、IIB、III化合物混合物之液晶介質，該混合物可為具良好負介電異向性之介質，以適用於動態矩陣定址之電光顯示器及IPS顯示器，證據8說明書段落【0105】及第11頁揭示該式I之優選化合物可具有CC-n-V1結構，且實施例1至4、6至10顯示含有CC-3-V1化合物含量為4-12重量%，證據8說明書段落【0068】～【0071】段所示式(I)之優選化合物之含量可大於3重量%，較佳25重量%，更佳5-25重量%，該說明書段落【0035】～【0039】、【0047】所示式IIA及/或式IIB總量至少為20重量%；經查該等化合物可分別對應於系爭專利請求項1所界定之通式(I)、(II)、(IIIb-1)、(IV)、(IIIa)所示者，且符合通式(I)、(II)、(IIIb-1)者所界定之含量百分比，證據8與該系爭專利請求項1比對結果簡示如下表：

系爭專利請求項1與證據8之比對		
技術特徵	請求項1之記載	證據8揭示之內容
A		

	通式(I) 含有 2-25 質量%  （式中，R^{11}表示碳原子數1~3之烷基，R^{22}表示碳原子數1~3之烷基或氧原子）	說明書第11頁所述式I之優選化合物（CC-n-V1） 實施例1至4、6至10揭示含有4-12重量%  （其中n、m為1至6） 當n為1至3時，對應系爭專利通式（I）
比對結果	當該式CC-n-V1化合物含量為4~12%且n=1~3時，即符合系爭專利請求項1所界定R11為碳數1~3之烷基、R22為碳數1之烷基	
技術特徵	請求項1之記載	證據8揭示之內容
B	通式(II) 含有 3-9.5 質量%  （式中，R^1為碳原子數1~8之烷基、R^2表示碳原子數1~8之烷氧基）	說明書第8頁第[0068]段所述式I之優選化合物 含有>3重量%，較佳≥5重量%，更佳5-25重量%  （其中R^{29}定義與R^{11}相同，即可為具有至多15個碳數的烷基，m為1-6） 當R^{29}為C_{1-8}烷基時，m為1-6時，對應系爭專利通式（II）
比對結果	證據8所揭露5%式I化合物之R29為碳數1~8之烷基且m=1~6時，即符合系爭專利請求項1所界定式(II)化合物中R1為碳數1~8之烷基、R2為碳數1~6之烷(氧)基	
技術特徵	請求項1之記載	證據8揭示之內容
C	通式(IIIb-1) 含有 5-25 質量% 	式IIA 至少為20重量%  （其中R^2定義與R^{11}相同，即可為具有至多15個碳數的烷基，p為1或2，且v為1至6） 當p=2、R^2為3個碳數之烷基，且V=2時，對應系爭專利通式（IIIb-1）
比對結果	證據8所揭露20%式IIA化合物之R2為碳數3之烷基且p=2、v=2時，即符合系爭專利請求項1所界定該式(IIIb-1)化合物	
技術特徵	請求項1之記載	證據8揭示之內容
D	通式(IIIa)  （式中，R^{3a}及R^{4a}分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	

		式IIA 至少為20重量%  （其中R^2定義與R^{11}相同，即可為具有至多15個碳數的烷基，p為1或2，且v為1至6）當p=1、R^2為C_{1-8}烷基時，對應
比對結果	證據8所揭露式IIA化合物之R2為碳數1~8之烷基且p=1、v=1~6時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IIIa)化合物中R3a為碳數1~8之烷基、R4a為碳數1~6之烷(氧)基	
技術特徵	請求項1之記載	證據8揭示之內容
E	通式(IV)  （式中，R^5及R^6分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	式IIB  （其中R^2定義與R^{11}相同，即可為具有至多15個碳數的烷基，p為1或2，且v為1至6）當R^2為C_{1-8}烷基時，對應系爭專利通式（IV）
比對結果	證據8所揭露式IIB化合物之R2為碳數1~8之烷基且v=1~6時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IV)化合物中R5為碳數1~8之烷基、R6為碳數1~6之烷(氧)基	
技術特徵	請求項1之記載	證據8揭示之內容
F	不含有具有環己烯基（cyclohexenylene）環之化合物	未揭示須以具有環己烯基環之化合物為必要成分
比對結果	當證據8之組合物不包含具有環己烯基環之化合物時，即符合系爭專利請求項1所界定者	

⑵、綜上可知，證據8與系爭專利請求項1之差異主要在於證據8未特定揭露如系爭專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等，另查熟習該項技術者縱使基於證據8所示良好異向性等性質，雖有可能嘗試調整證據8所示混合物液晶介質之成分組成，然由於證據8並未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，尚難謂熟習該項技術者基於該證據所揭示者能

完成如系爭專利請求項1之能達成該等功效的組成物，且該組成物之該等功效亦非基於證據8或系爭專利申請日前之通常知識可推論得知的，故亦難謂該等功效係可合理預期的，是以系爭專利請求項1發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據8不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

２、證據8不足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

⑴、系爭專利請求項3之技術特徵，業如前述，查系爭專利請求項3與系爭專利請求項1之差異主要在於：(1)式(II)化合物之含量為3~25質量%；(2)關於式(IIIa)化合物調整為「進而含有1種或2種以上之選自通式（III）所表示之化合物群中之化合物，並含有1種或2種以上之通式（IIIa）所表示之化合物來作為上述通式（III）所表示之化合物」；(3)增列「並進而含有1種或2種以上之選自由式（V-5）所表示之化合物群中之化合物」。

⑵、次查，證據8說明書段落【0068】所述式I之優選化合物之含量為大於3重量％，且最佳含量為5-25重量％，該等含量範圍與系爭專利請求項3通式(II)之含量範圍相符；另證據8所揭式IIA化合物中，當其p為1或2、R2為碳數1~8之烷基，且排除碳數為3之烷基時，即可對應於系爭專利請求項3通式（III）；證據8說明書第7頁段落【0066】所列示式I之優選化合物（第18個），可對應系爭專利請求項3之通式（V-5）化合物。

⑶、綜上，證據8與系爭專利請求項3之差異主要仍在於證據8未特定揭露如系爭專利請求項3所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據8亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是以依前開說明，應認系爭專利請求項3發明之整體，並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據8自不足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

３、證據8不足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

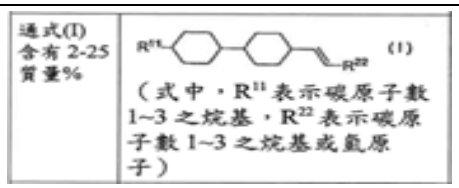
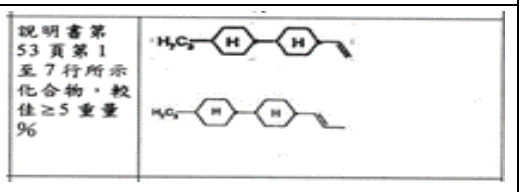
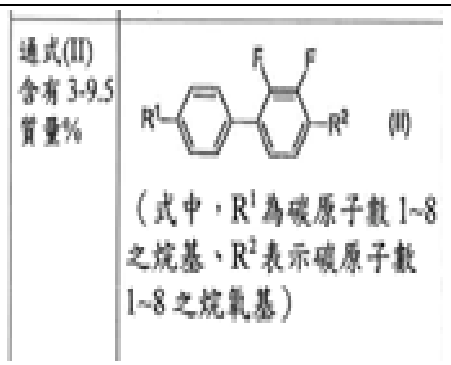
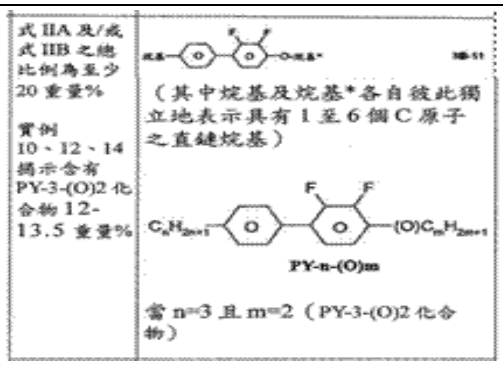
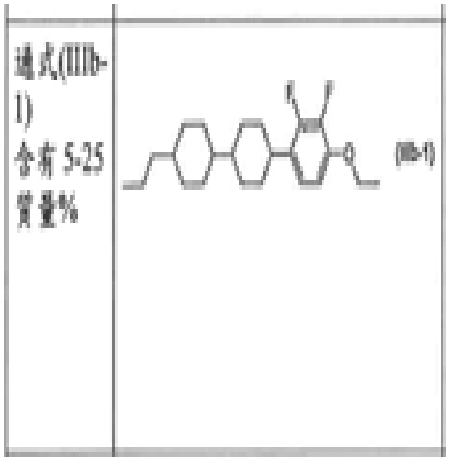
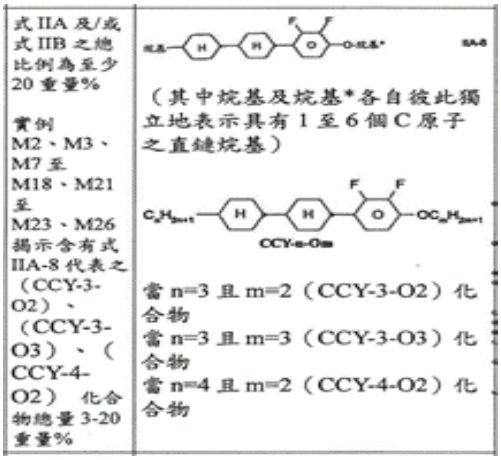
系爭專利請求項6係為依附於系爭專利請求項1或2之附屬項，於解釋該請求項之專利權範圍時應包含系爭專利請求項1或2之所有技術特徵。據此，如前所述，證據8已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，而系爭專利請求項6既依附於請求項1或2，則證據8當然亦不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

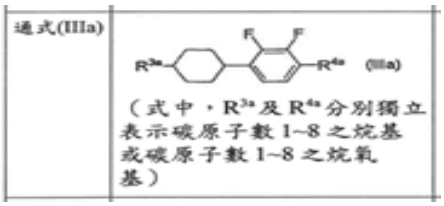
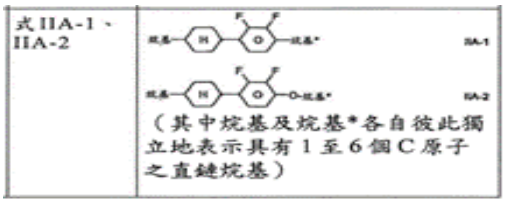
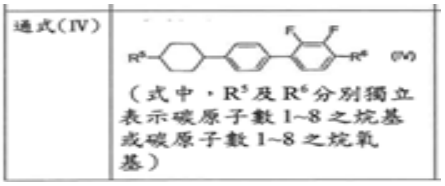
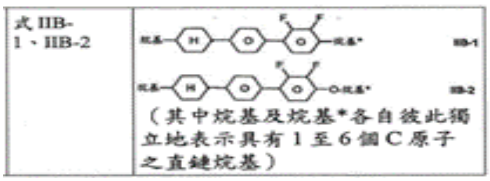
㈥、證據9不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性：

１、證據9不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

⑴、系爭專利請求項1之技術特徵，業經說明如前，而系爭專利請求項1與證據9相較，證據9說明書第4頁第3至21行、第14頁第21行至第15頁第1行、第16頁第2至4行及第43頁第10行至第44頁第17行揭示一種包含式I化合物混合物之液晶介質，其可具有極低旋轉黏度值、高介電異向性、低溫穩定性等性質，該液晶介質可應用於LC顯示器，且式I化合物中可額外包含選自如式 IIA、IIB、IIC之化合物；證據9說明書第53頁第1至7行揭示液晶介質可額外包含總量較佳大於5重量%之二特定化合物；證據9說明書第45至46頁、第49至50頁揭示式IIA、IIB及IIC可包含如式IIB-11、式IIA-8、式IIA-1與IIA-2、式IIB-1與IIB-2之較佳化合物結構；經查該等化合物可分別對應於系爭專利請求項1所界定之通式(I)、(II)、(IIIb-1)、(IIIa)、(IV)所示者，且符合通式(I)者所界定之含量百分比。另證據9說明書第51頁第10至11行揭示式IIA及/或IIB之化合物於混合物之總比例較佳為至少20重量%，且上開說明書第156至166頁實例M2、M3、M7~M18、M21~M23、M26揭示含有式IIA-8代表之CCY-3-O2等化合物即符合系爭專利請求項1所界定之(IIIb-1)化合物，故證據9亦實質揭示了符合系爭專利請求項1所界定(IIIb-1)化合物之含量百分比；證據9與系爭專利請求項1比對結果簡示如下表：

系爭專利請求項1與證據9之比對		
技術	請求項1之記載	證據9揭示之內容

特徵		
A	通式(I) 含有 2-25 質量%  （式中，R^{11}表示碳原子數1~3之烷基，R^{22}表示碳原子數1~3之烷基或氫原子）	說明書第53頁第1至7行所示化合物，較佳≥5重量% 
比對結果	當該二特定化合物含量為5~25%時，即符合系爭專利請求項1所界定R11為碳數3之烷基、R22為碳數1之烷基或氫原子	
技術特徵	請求項1之記載	證據9揭示之內容
B	通式(II) 含有 3-9.5 質量%  （式中，R^1為碳原子數1~8之烷基，R^2表示碳原子數1~8之烷氧基）	式IIA及/或式IIB之總比例為至少20重量% 實例10、12、14揭示含有PY-3-(O)2化合物12-13.5重量%  （其中烷基及烷基*各自彼此獨立地表示具有1至6個C原子之直鏈烷基） PY-n-(O)m 當n=3且m=2（PY-3-(O)2化合物）
比對結果	證據9所揭露PY-3-(O)2化合物即符合系爭專利請求項1所界定式(II)化合物中R1為碳數3之烷基、R2為碳數2之烷(氧)基	
技術特徵	請求項1之記載	證據9揭示之內容
C	通式(IIIb-1) 含有 5-25 質量% 	式IIA及/或式IIB之總比例為至少20重量% 實例M2、M3、M7至M18、M21至M23、M26揭示含有式IIA-8代表之（CCY-3-O2）、（CCY-3-O3）、（CCY-4-O2）化合物總量3-20重量%  （其中烷基及烷基*各自彼此獨立地表示具有1至6個C原子之直鏈烷基） CCY-n-Om 當n=3且m=2（CCY-3-O2）化合物 當n=3且m=3（CCY-3-O3）化合物 當n=4且m=2（CCY-4-O2）化合物
比對結果	證據9所揭露CCY-3-O2化合物即符合系爭專利請求項1所界定式(IIIb-1)化合物	

技術特徵	請求項1之記載	證據9揭示之內容
D	通式(IIIa)  （式中，R^{3a}及R^{4a}分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	式IIA-1、IIA-2  （其中烷基及烷基*各自彼此獨立地表示具有1至6個C原子之直鏈烷基）
比對結果	證據9所揭露式IIA-1、IIA-2化合物之烷基、烷基*各自獨立地表示1~6個碳原子之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IIIa)化合物中R3a為碳數1~6之烷基、R4a為碳數1~6之烷(氧)基	
技術特徵	請求項1之記載	證據9揭示之內容
E	通式(IV)  （式中，R^5及R^6分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	式IIB-1、IIB-2  （其中烷基及烷基*各自彼此獨立地表示具有1至6個C原子之直鏈烷基）
比對結果	證據9所揭露式IIB-1、IIB-2化合物之烷基、烷基*各自獨立地表示1~6個碳原子之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IV)化合物中R5為碳數1~6之烷基、R6為碳數1~6之烷(氧)基	
技術特徵	請求項1之記載	證據9揭示之內容
F	不含有具有環己烯基（cyclohexenylene）環之化合物	未揭示須以具有環己烯基環之化合物為必要成分
比對結果	當證據9之組合物不包含具有環己烯基環之化合物時，即符合系爭專利請求項1所界定者	

⑵、綜上，證據9與系爭專利請求項1之差異主要在於證據9未特定揭露如系爭專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等，另查熟習該項技術者縱使基於證據9所示良好異

向性等性質雖有可能嘗試調整證據9所示混合物液晶介質之成分組成，然由於證據9並未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，尚難謂熟習該項技術者基於證據9所揭示者能完成如系爭專利請求項1之能達成該等功效的組成物，且該組成物之該等功效亦非基於證據9或系爭專利申請日前之通常知識可推論得知，故亦難謂該等功效係可合理預期，是以系爭專利請求項1發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據9不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2、證據9不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

系爭專利請求項2之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，已如前述，查證據9說明書第45頁、第49頁所揭示式IIA-1與IIA-2、式IIB-2化合物之結構可對應於系爭專利請求項2之化合物（IIIa-1）~（IIIa-8）、（IV-1）~（IV-4）；證據9說明書第61至62頁揭示式O-16、O-19及O-15化合物之結構可對應於系爭專利請求項2之化合物（VI-a）、（VI-d）、（VI-e）；且證據9說明書第52頁、第58頁、第59頁揭示式IIIa與IIIb、B-1與B-4、B-2c化合物之結構可對應於系爭專利請求項2之化合物（VI-b）、（VI-c）、（VI-c5）。故證據9與系爭專利請求項2之差異主要仍在於證據9未特定揭露如系爭專利請求項2所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據9亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是以依前開說明，系爭專利請求項2發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據9當不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

3、證據9不足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

系爭專利請求項3之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業經本院說明如前，查證據9已揭示式IIA及/或IIB之化合物於混合物之總比例較佳為至少20重量%，且實例

10、12、14顯示式IIB代表之PY-n-(O)m化合物含量為12~13.5重量%，可對應於系爭專利請求項3所界定（II）之含量範圍；該證據所揭示IIA-1、式IIA-2、式IIA-8之結構，可對應系爭專利請求項3通式(III)之n=0或n=1之化合物結構；證據9說明書第51頁所示式IIC-1化合物之結構，亦可對應系爭專利請求項3之通式(V-5)化合物。是以證據9與系爭專利請求項3之差異主要仍在於證據9未特定揭露如系爭專利請求項3所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且該證據亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，從而，依前開說明，應認系爭專利請求項3發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據9當不足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

4、證據9不足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

系爭專利請求項4之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，另證據9說明書第61至62頁揭示式O-16、O-19及O-15化合物之結構可對應於系爭專利請求項4之化合物（VI-a）、（VI-d）、（VI-e）；證據9說明書第51頁所示式IIC-1化合物之結構，可對應系爭專利請求項4通式(V)化合物(之下位概念化合物(V-5))；且證據9說明書第53至54頁所示其液晶介質可額外包括之式V-5至式V-9之化合物，亦可對應於系爭專利請求項4 通式(V)化合物之結構；惟證據9並未明確揭露其必要成分與任意成分化合物之合計含量須為95質量%以上且100質量%以下之技術內容。故證據9與系爭專利請求項4之差異主要仍在於證據9未特定揭露如系爭專利請求項4所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據9亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，故依前述說明，系爭專利請求項4發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，自難以證據9證明系爭專利請求項4不具進步性。

5、證據9不足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

系爭專利請求項5之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，均經本院論述如前，查證據9說明書第53頁第2行及第7行所示化合物，可對應於系爭專利請求項5之化合物（I-1）、（I-3）；而證據9說明書第45頁、第49頁所揭示式IIA-1與IIA-2、式IIB-2化合物之結構可對應於系爭專利請求項5之化合物（IIIa-1）~（IIIa-8）、（IV-1）~（IV-4）；證據9說明書第62至63頁揭示式O-16化合物及較佳式O-16c、式O-16a、式O-16d所示化合物，可對應系爭專利請求項5之通式(VI-a5)、(VI-a3)、(VI-a4)之化合物。故證據9與系爭專利請求項5之差異主要仍在於證據9未特定揭露如系爭專利請求項5所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據9亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，是以依前開說明及論述，系爭專利請求項5發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據9不足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

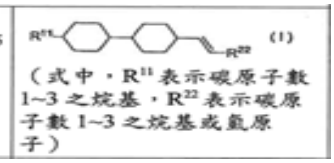
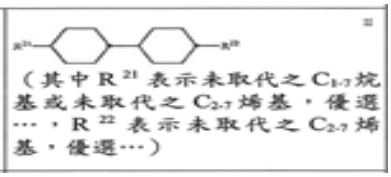
6、證據9不足以證明系爭專利請求項6至7不具進步性：

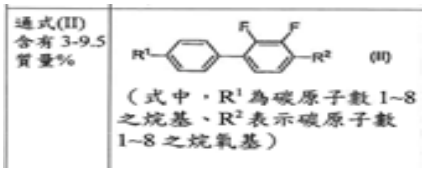
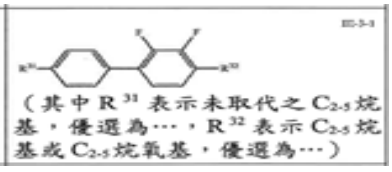
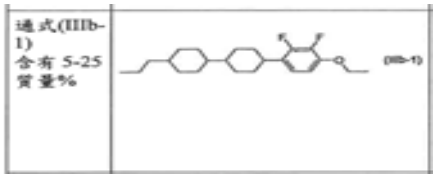
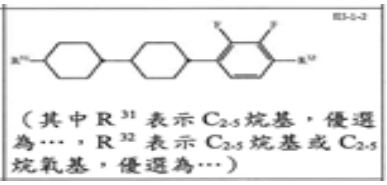
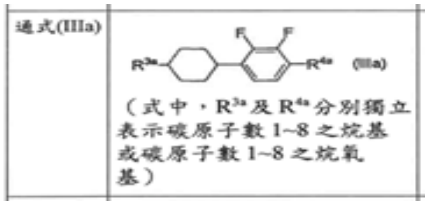
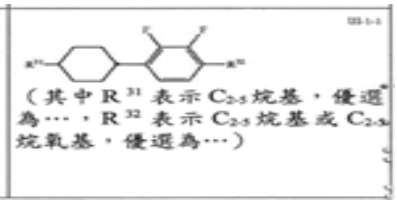
系爭專利請求項6係依附於系爭專利請求項1或2 之附屬項，於解釋系爭專利請求項6之專利權範圍時應包含系爭專利請求項1或2之所有技術特徵。據此，如前所述，證據9已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，而系爭專利請求項6既依附於請求項1或2，則證據9當然亦不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。又系爭專利請求項7係為依附於系爭專利請求項1或2之附屬項，於解釋系爭專利請求項7之專利權範圍時應包含系爭專利請求項1或2之所有技術特徵。故依前開說明，證據9已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，而系爭專利請求項7既依附於請求項1或2，則證據9當然亦不足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

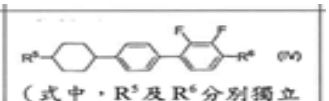
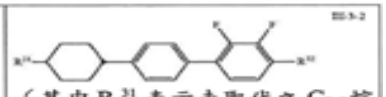
㈦、證據10不足以證明系爭專利請求項1至4、6至7不具進步性：

１、證據10不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

⑴、系爭專利請求項1之技術特徵，業如前述，查系爭專利請求項1與證據10相較，證據10說明書段落【0040】至【0042】、【0047】、【0071】至【0079】揭示一種液晶介質化合物的混合物，其可包含至少一種式I化合物和一種或多種式II化合物，且優選另外一種或多種選自式III-1至III-4的化合物，該混合物具有良好的低溫穩定性、旋轉黏度及高負介電異向性、低溫穩定性等性質，並可應用於具有ECB效應之主動矩陣定址之電光顯示器及用於IPS顯示器；證據10說明書【0071】至【0074】揭示式II化合物、【0149】~【0151】與【0144】等段落揭示式III-3化合物之較佳態樣為式III-3-1及式III-3-2之化合物與式III-1化合物之較佳態樣為式III-1-1及式III- 1-2之化合物；經查該等化合物可分別對應於系爭專利請求項1所界定之通式(I)、(II)、(IV)、(IIIa)、(IIIb-1)所示者。另證據10說明書段落【0137】、【0139】揭示該混合物中可包含式II化合物含量為5%至90%，優選含量為10%至80%，最優選含量為20%至70%，並可包含式III-1及式III-3化合物含量各5%至30%，亦可對應系爭專利請求項1所界定通式(I)、(II)、(IIIb-1)之化合物含量；證據10與系爭專利請求項1比對結果簡示如下表：

系爭專利請求項1與證據10之比對		
技術特徵	請求項1之記載	證據10揭示之內容
A	通式(I) 含有 2-25 質量%  （式中，R^{11}表示碳原子數1~3之烷基，R^{22}表示碳原子數1~3之烷基或氫原子）	式II 含量為 5%至 90%，優選含量為 10%至 80%，最優選含量為 20%至 70%  （其中 R^{21} 表示未取代之 C_{1-7} 烷基或未取代之 C_{2-7} 烯基，優選…，R^{22} 表示未取代之 C_{2-7} 烯基，優選…）
比對結果	當證據10所揭露式II化合物含量為5~25%，且R21為碳數1~3之烷基、R22為碳數2~4之烯基時，即符合系爭專利請求項1所界定R11為碳數1~3之烷基、R22為碳數1~3之烷基	
技術	請求項1之記載	證據10揭示之內容

特徵		
B	通式(II) 含有3-9.5 質量%  （式中，R^1為碳原子數1~8之烷基、R^2表示碳原子數1~8之烷氧基）	式III-3-1 含量5%至30%  （其中R^{31}表示未取代之C_{2-5}烷基，優選為…，R^{32}表示C_{2-5}烷基或C_{2-5}烷氧基，優選為…）
比對結果	當證據10所揭露式III-3-1化合物含量為5~25%，且R31為碳數2~5之烷基、R22為碳數2~5之烷氧基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(II)化合物中R1為碳數2~5之烷基、R2為碳數2~5之烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據10揭示之內容
C	通式(IIIb-1) 含有5-25 質量% 	式III-1-2 含量5%至30%  （其中R^{31}表示C_{2-5}烷基，優選為…，R^{32}表示C_{2-5}烷基或C_{2-5}烷氧基，優選為…）
比對結果	當證據10所揭露式III-1-2化合物含量為5~25%，且R31為碳數3之烷基、R22為碳數2之烷氧基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IIIb-1)化合物	
技術特徵	請求項1之記載	證據10揭示之內容
D	通式(IIIa)  （式中，R^{3a}及R^{4a}分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	式III-1-1  （其中R^{31}表示C_{2-5}烷基，優選為…，R^{32}表示C_{2-5}烷基或C_{2-5}烷氧基，優選為…）
比對結果	當證據10所揭露式III-1-1化合物含量中R31為碳數2~5之烷基、R22為碳數2~5之烷基或烷氧基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IIIa)化合物中R3a為碳數2~5之烷基、R4a為碳數2~5之烷基或烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據10揭示之內容
E		

	通式(IV)  （式中，R^5及R^6分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	式III-3-2  （其中R^{31}表示未取代之C_{2-5}烷基，優選為…，R^{32}表示C_{2-5}烷基或C_{2-5}烷氧基，優選為…）
比對結果	該證據10所揭露式III-3-2化合物含量中R31為碳數2~5之烷基、R22為碳數2~5之烷基或烷氧基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IV)化合物中R5為碳數2~5之烷基、R6為碳數2~5之烷基或烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據10揭示之內容
F	不含有具有環己烯基（cyclohexenylene）環之化合物	未揭示須以具有環己烯基環之化合物為必要成分
比對結果	當證據10之組合物不包含具有環己烯基環之化合物時，即符合系爭專利請求項1所界定者	

⑵、綜上，證據10與系爭專利請求項1之差異主要在於證據10未特定揭露如系爭專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等，另查熟習該項技術者縱使基於證據10所示良好異向性等性質雖有可能嘗試調整證據10所示混合物液晶介質之成分組成，然由於證據10並未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，尚難謂熟習該項技術者基於證據10所揭示者能完成如系爭專利請求項1之能達成該等功效的組成物，且該組成物之該等功效亦非基於證據10或系爭專利申請日前之通常知識可推論得知的，故亦難謂該等功效係可合理預期，因此，系爭專利請求項1發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，是證據10不能證明系爭專利請求項1不具有進步性。

２、證據10不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

系爭專利請求項2之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，查證據10說明書段落【0144】、【01

49】所揭示式III-1-1、式III-3-2化合物之結構可對應於系爭專利請求項2之化合物（IIIa-1）~（IIIa-8）、（IV-1）~（IV-4）；證據10說明書段落【0071】至【0074】、【0179】~【0182】所揭示式該混合物優選包含之式V-1~V-4化合物的結構可對應於系爭專利請求項2之化合物（VI-a）~（VI-e），其中，該V-2化合物即相當於系爭專利請求項2之化合物（VI-c5）；且證據10說明書段落【0156】所揭示式V之化合物總含量為30~80重量%，亦可對應系爭專利請求項2「選自式（VI-a)～（VI-e)所表示之化合物群中之化合物其含量的合計為30～40質量%」之技術特徵。由前開說明可知，證據10與系爭專利請求項2之差異主要仍在於證據10未特定揭露如系爭專利請求項2所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據10亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，故同前述之理，系爭專利請求項2發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，是證據10不足以證明系爭專利請求項2不具有進步性。

3、證據10不足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

系爭專利請求項3之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，查證據10已揭示其式III-3-1化合物含量為5%至30%，可對應於系爭專利請求項3所界定（II）之含量範圍；證據10之III-1-1之結構，可對應系爭專利請求項3通式（III)之n=0之化合物結構；證據10說明書段落【[0075】至【0079】所示式III-4化合物之結構，亦可對應系爭專利請求項3之通式(V-5)化合物。是以證據10與系爭專利請求項3之差異主要仍在於證據10未特定揭露如系爭專利請求項3所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且該證據亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，故同前述說明，系爭專利請求項3發明之整體並非熟習該項技術者

基於前述先前技術能輕易完成，證據10不足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

4、證據10不足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

系爭專利請求項4之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，查證據10所揭示III-1-1之結構，可對應系爭專利請求項4通式（III)之n=0之化合物結構；證據10說明書段落【0071】至【0074】、【0179】至【0182】所揭示式V-1～V-4化合物之結構可對應於系爭專利請求項4之化合物（VI-a）~（VI-e）；且證據10說明書段落【0075】至【0079】所示式III-4化合物之結構，亦可對應系爭專利請求項4通式(V)化合物(之下位概念化合物(V-5))；惟證據10並未明確揭露其必要成分與任意成分化合物之合計含量須為95質量%以上且100質量%以下之技術內容。是以證據10與系爭專利請求項4之差異主要仍在於證據10未特定揭露如系爭專利請求項4所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據10亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，故同前述之理，系爭專利請求項4發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據10不足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

5、證據10不足以證明系爭專利請求項6至7不具進步性：

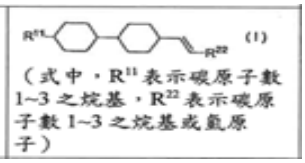
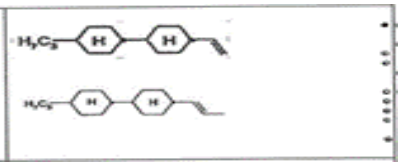
系爭專利請求項6係為依附於系爭專利請求項1或2之附屬項，於解釋系爭專利請求項6之專利權範圍時應包含系爭專利請求項1或2之所有技術特徵。是以，如前所述，證據10已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，而系爭專利請求項6既依附於請求項1或2，則證據10當然亦不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。另系爭專利請求項7係為依附於系爭專利請求項1或2之附屬項，於解釋系爭專利請求項7之專利權範圍時應包含系爭專利請求項1或2之所有技術特徵，故如前所述，證據10已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進

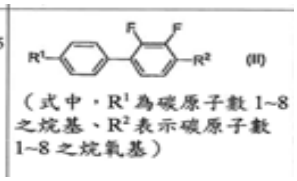
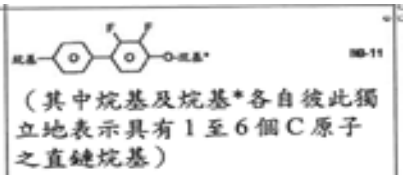
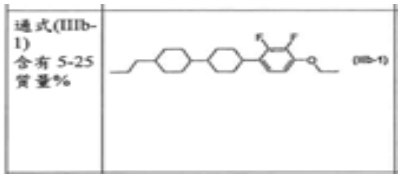
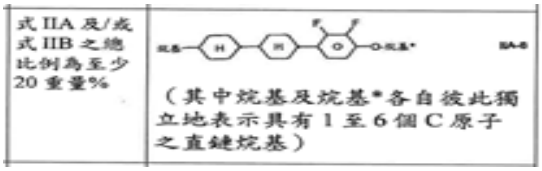
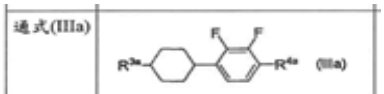
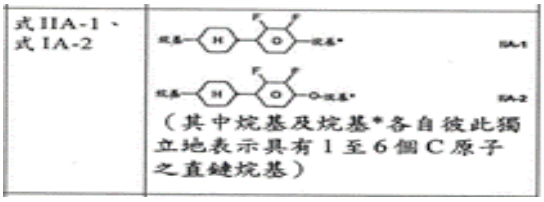
步性，而系爭專利請求項7既依附於請求項1或2，則證據10當然亦不足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

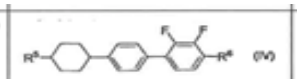
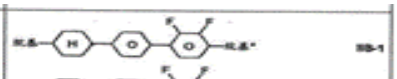
㈧、證據11不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性：

１、證據11不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

⑴、系爭專利請求項1之技術特徵，業如前述，以系爭專利請求項1與證據11相較，證據11說明書第12頁第22行至第13頁第2行、第45頁第1至6行揭示一種具有高負介電異向性、良好穩定性之液晶介質，其可應用於LC顯示器，該液晶介質可包含至少一種選自式IA、IB、1C及ID化合物群之添加劑，且其較佳實施例係另外包含一或多種選自式IIA、IIB及IIC化合物群之化合物之液晶介質；證據11說明書第46至47頁、第54至55頁揭示IIA、IIB及IIC之較佳化合物結構可包含如式IIB-11、式IIA-8、式IIA-1及IIA-2、式IIB-1及IIB-2 之化合物；證據11說明書第58頁第8至14並揭示該液晶化合物可額外包含總量較佳大於5重量%之二特定化合物；經查該等化合物可分別對應於系爭專利請求項1所界定之通式(II)、(IIIb-1)、(IIIa)、(IV)、(I)所示者。另證據11說明書第56頁第13至14行揭示式IIA及/或式IIB化合物之總比例較佳者為至少20重量%，可對應系爭專利請求項1所界定通式(IIIb-1)之化合物含量；證據11與系爭專利請求項1比對結果簡示如下表：

系爭專利請求項1與證據11之比對		
技術特徵	請求項1之記載	證據11揭示之內容
A	通式(I)含有2-25質量%  （式中，R^{11}表示碳原子數1~3之烷基，R^{22}表示碳原子數1~3之烷基或氫原子）	說明書第58頁第8至14行所示化合物，較佳總量為≥5重量% 
比對結果	當該二特定化合物含量為5~25%時，即符合系爭專利請求項1所界定R11為碳數3之烷基、R22為碳數1之烷基或氫原子	

技術特徵	請求項1之記載	證據11揭示之內容
B	通式(II) 含有 3-9.5 質量%  （式中，R^1為碳原子數 1~8 之烷基、R^2表示碳原子數 1~8 之烷氧基）	式 IIA 及/或式 IIB 之總比例為至少 20 重量%  （其中烷基及烷基*各自彼此獨立地表示具有 1 至 6 個 C 原子之直鏈烷基）
比對結果	當證據11所揭露式IIB-11化合物之烷基、烷基*為碳數1~6之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(II)化合物中R1為碳數1~6之烷基、R2為碳數1~6之烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據11揭示之內容
C	通式(IIIb-1) 含有 5-25 質量% 	式 IIA 及/或式 IIB 之總比例為至少 20 重量%  （其中烷基及烷基*各自彼此獨立地表示具有 1 至 6 個 C 原子之直鏈烷基）
比對結果	當證據11所揭露式IIA-8化合物含量為20%，且其烷基為碳數3之直鏈烷基、烷基*為碳數2之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IIIb-1)化合物	
技術特徵	請求項1之記載	證據11揭示之內容
D	通式(IIIa)  （式中，R^{3a}及R^{4a}分別獨立表示碳原子數 1~8 之烷基或碳原子數 1~8 之烷氧基）	式 IIA-1、式 IA-2  （其中烷基及烷基*各自彼此獨立地表示具有 1 至 6 個 C 原子之直鏈烷基）
比對結果	當證據11所揭露式IIA-1、IIA-2化合物之烷基、烷基*為碳數1~6之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IIIa)化合物中R3a為碳數1~6之烷基、R4a為碳數1~6之烷基或烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據11揭示之內容
E		

	通式(IV)  （式中，R^5及R^6分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	式IIB-1、式IIB-2  （其中烷基及烷基*各自彼此獨立地表示具有1至6個C原子之直鏈烷基）
比對結果	證據11所揭露式IIB-1、IIB-2化合物之烷基、烷基*為碳數1~6之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IV)化合物中R5為碳數1~6之烷基、R6為碳數1~6之烷基或烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據11揭示之內容
F	不含有具有環己烯基（cyclohexenylene）環之化合物	未揭示須以具有環己烯基環之化合物為必要成分
比對結果	當證據11之組合物不包含具有環己烯基環之化合物時，即符合系爭專利請求項1所界定者	

⑵、綜上，證據11與系爭專利請求項1之差異主要在於證據11未特定揭露如系爭專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等，另查熟習該項技術者縱使基於證據11所示良好異向性等性質雖有可能嘗試調整該證據所示混合物液晶介質之成分組成，然由於證據11並未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，尚難謂熟習該項技術者基於該證據所揭示者能完成如系爭專利請求項1之能達成該等功效的組成物，且該組成物之該等功效亦非基於證據11或系爭專利申請日前之通常知識可推論得知的，故亦難謂該等功效係可合理預期的，因此，應認系爭專利請求項1發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據11不足以證明系爭專利請求項1不具有進步性。

2、證據11不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

系爭專利請求項2之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，又證據11說明書第46至47頁、第54至

55頁揭示IIA、IIB及IIC之較佳化合物結構如式IIA-1與IIA-2、式IIB-2 之化合物可對應於系爭專利請求項2之化合物（IIIa-1）~（IIIa-8）、（IV-1）~（IV-4）；證據11說明書第66至67頁所揭示該液晶介質可另包含之式O-16、O-19及O-15化合物的結構可對應於系爭專利請求項2之化合物（VI-a）、（VI-d）、（VI-e）；且證據11說明書第57頁第16行、第64頁第1與16行所示式IIIa、B-1與B-2、B-2c化合物之結構可對應於系爭專利請求項2之化合物（VI-b）、（VI-c）、（VI-c5）。是以證據11與系爭專利請求項2之差異主要仍在於證據11未特定揭露如系爭專利請求項2所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據11亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，故同前述之說明，系爭專利請求項2發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據11不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

3、證據11不足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

系爭專利請求項3之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，又證據11已揭示其式IIA及/或IIB化合物含量為至少20%，可對應於系爭專利請求項3所界定（II）之含量範圍；證據11之IIA-1、IIA-2之結構，可對應系爭專利請求項3通式(III)之n=0之化合物結構；證據11說明書第57頁第1至2行所示式IIC-1化合物之結構，亦可對應系爭專利請求項3之通式(V-5)化合物。故證據11與系爭專利請求項3之差異主要仍在於證據11未特定揭露如系爭專利請求項3所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據11亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，同前述說明，應認系爭專利請求項3發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據11不足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

4、證據11不足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

系爭專利請求項4之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，查證據11所揭示IIA-1、IIA-2之結構，可對應系爭專利請求項4通式(III)之n=0之化合物結構；證據11說明書所示式0-16、0-19及0-15化合物的結構可對應於系爭專利請求項4之化合物（VI-a）、（VI-d）、（VI-e）；且證據11說明書第57頁第1至2行所示式IIC-1化合物之結構，亦可對應系爭專利請求項4通式(V)化合物(之下位概念化合物(V-5))；惟證據11並未明確揭露其必要成分與任意成分化合物之合計含量須為95質量%以上且100質量%以下之技術內容。是以證據11與系爭專利請求項4之差異主要仍在於證據11未特定揭露如系爭專利請求項4所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據11亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，因此，同前述理由，系爭專利請求項4發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據11不足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

5、證據11不足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

系爭專利請求項5之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，查證據11說明書第58頁第8至14行所示化合物可對應於系爭專利請求項5之化合物(I-1)、(I-2)、(I-3)；證據11說明書第67至68頁揭示式0-16化合物及較佳式0-16c、式0-16a、式0-16d所示化合物，可對應系爭專利請求項5之通式(VI-a5)、(VI-a3)、(VI-a4)之化合物。是以證據11與系爭專利請求項5之差異主要仍在於證據11未特定揭露如系爭專利請求項5所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據11亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，因此，同前述理由，系爭專利請求項5發

明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據11不足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

6、證據11不足以證明系爭專利請求項6至7不具進步性：

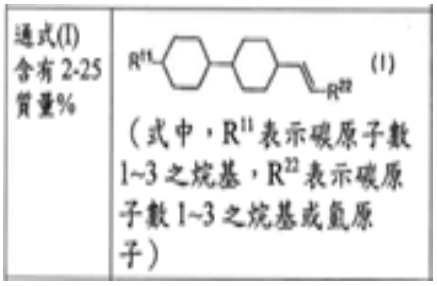
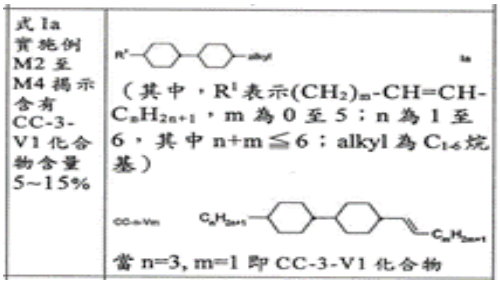
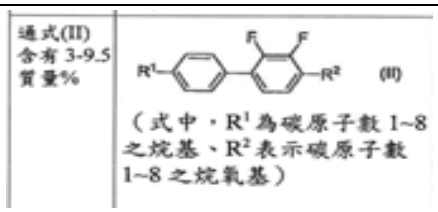
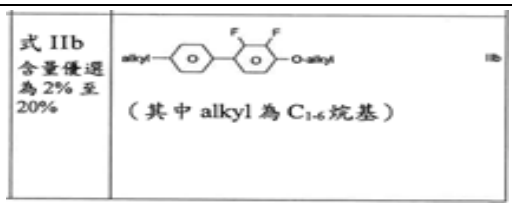
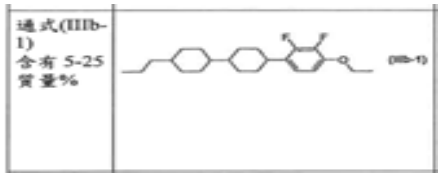
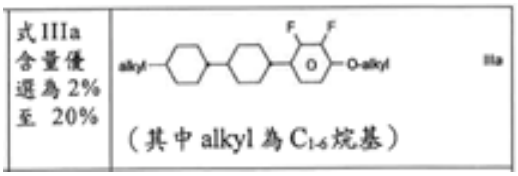
系爭專利請求項6係為依附於系爭專利請求項1或2之附屬項，於解釋系爭專利請求項6之專利權範圍時應包含請求項1或2之所有技術特徵。據此，如本院前開說明，證據11已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，而系爭專利請求項6既依附於系爭專利請求項1或2，則證據11當然亦不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。又系爭專利請求項7為依附於系爭專利請求項1或2之附屬項，於解釋系爭專利請求項7之專利權範圍時應包含系爭專利請求項1或2之所有技術特徵。據此，如前所述，證據11已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，而系爭專利請求項7既依附於系爭專利請求項1或2，則證據11當然亦不足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

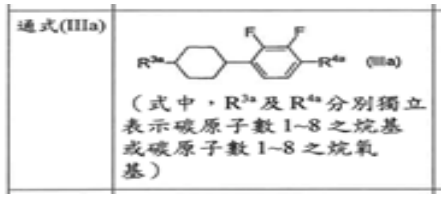
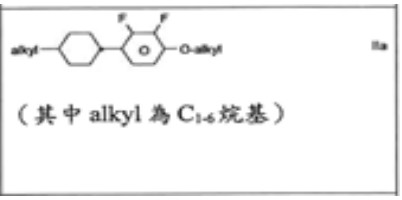
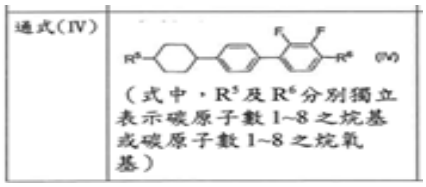
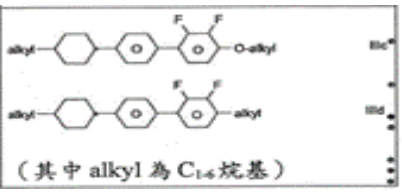
㈨、證據12不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性：

1、證據12不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

⑴、系爭專利請求項1之技術特徵，業如前述，系爭專利請求項1與證據12相較，證據12說明書段落【0021】至【0026】、【0046】至【0054】揭示一種包含(通)式I、II、III等化合物之混合物液晶介質，該混合物可為具良好負介電異向性之介質，以適用於主動矩陣之顯示器，其中，前述通式之較佳態樣可為式Ia、IIb、IIIa、IIa、IIIc與IIId所示者；證據12說明書第26頁第35行、段落【0076】至【0078】、實施例M2至M4揭示在液晶混合物N1添加式Ia下位概念化合物CC-3-V1之含量可為5至15%等，證據12說明書段落【0046】、第20頁第20至24行揭示其液晶介質整個混合物中式II化合物的比例優選為5至60%，特別優選為10至35%，證據12說明書第20頁第30至34行揭示其液晶介質整個混合物中式IIIa和IIIc化合物的比例為整體優選為5至60%，特別優選為10至35%；經查該等化合物可分別對應於系爭專利請求項1所界定之通

式(I)、(II)、(IIIb-1)、(IIIa)、(IV)所示者，且符合通式(I)、(II)、(IIIb-1)者所界定之含量百分比，證據12與系爭專利請求項1比對結果簡示如下表：

系爭專利請求項1與證據12之比對		
技術特徵	請求項1之記載	證據12揭示之內容
A	通式(I) 含有2-25 質量%  	式Ia 實施例M2至M4揭示含有CC-3-V1化合物含量5~15% 
比對結果	該式Ia之下位概念化合物CC-3-V1含量為5~15%時，即符合系爭專利請求項1所界定R11為碳數3之烷基、R22為碳數1之烷基	
技術特徵	請求項1之記載	證據12揭示之內容
B	通式(II) 含有3-9.5 質量%  	式IIb 含量優選為2%至20% 
比對結果	當證據12所揭露式IIb化合物之alkyl為碳數1~6之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(II)化合物中R1為碳數1~6之烷基、R2為碳數1~6之烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據12揭示之內容
C	通式(IIIb-1) 含有5-25 質量% 	式IIIa 含量優選為2%至20% 
比對結果	當證據12所揭露式IIIa化合物含量為2~10%，且其左alkyl為3之直鏈烷基、右alkyl為碳數2之直鏈烷基時，即符	

	合系爭專利請求項1所界定式(IIIb-1)化合物	
技術特徵	請求項1之記載	證據12揭示之內容
D	通式(IIIa)  （式中，R^{3a}及R^{4a}分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	式IIa 含量優選為2%至20%  （其中alkyl為C_{1-6}烷基）
比對結果	當證據12所揭露式IIa化合物之alkyl為碳數1~6之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IIIa)化合物中R3a為碳數1~6之烷基、R4a為碳數1~6之烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據12揭示之內容
E	通式(IV)  （式中，R^5及R^6分別獨立表示碳原子數1~8之烷基或碳原子數1~8之烷氧基）	式IIIc 含量優選為2%至20% 式IIId  （其中alkyl為C_{1-6}烷基）
比對結果	證據12所揭露式IIIc、IIId化合物之alkyl為碳數1~6之直鏈烷基時，即符合系爭專利請求項1所界定式(IV)化合物中R5為碳數1~6之烷基、R6為碳數1~6之烷基或烷氧基	
技術特徵	請求項1之記載	證據12揭示之內容
F	不含有具有環己烯基（cyclohexenylene）環之化合物	未揭示須以具有環己烯基環之化合物為必要成分
比對結果	當證據12之組合物不包含具有環己烯基環之化合物時，即符合系爭專利請求項1所界定者	

⑵、綜上，證據12與系爭專利請求項1之差異主要在於證據12未特定揭露如系爭專利請求項1所界定之成分組合、部分成分含量範圍等，另查熟習該項技術者縱使基於證據12所示良好異向性等性質雖有可能嘗試調整證據12所示混合物液晶介質

之成分組成，然由於證據12並未揭示其混合物能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，尚難謂熟習該項技術者基於證據12所揭示者能完成如系爭專利請求項1之能達成該等功效的組成物，且該組成物之該等功效亦非基於證據12或系爭專利申請日前之通常知識可推論得知的，故亦難謂該等功效係可合理預期的，因此，系爭專利請求項1發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據12不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2、證據12不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

系爭專利請求項2之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，查證據12說明書第12頁第【0046】段第40行、第13頁第15行與第45行揭示式II、式III之結構及其較佳化合物結構，其中式II之化合物、式IIa之化合物、式IIIc 之化合物可對應於系爭專利請求項2之化合物（IIIa-5）~（IIIa-8）、（IIIa-1）~（IIIa-4）、（IV-1）~（IV-4）；證據12說明書第16頁第40行至第17頁第21行所揭示該液晶介質可另包含之式VIIa~VIIf化合物的結構可對應於系爭專利請求項2之化合物（VI-b）、（VI-c）、（VI-a）、（VI-d）、（VI-e）；且證據12說明書第20頁第48至49行揭示式VII至XV化合物在混合物中之含量整體為10~70%，優選為10~60%，亦可對應於系爭專利請求項2「選自式(VI-a)～(VI-e)所表示之化合物群中之化合物其含量的合計為30～40質量%」之技術特徵。是以證據12與系爭專利請求項2之差異主要仍在於證據12未特定揭露如系爭專利請求項2所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據12亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，故同前述之說明，系爭專利請求項2發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據12不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

3、證據12不足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

系爭專利請求項3之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，查證據12已揭示其式IIb化合物含量優選為2~20%，可對應於系爭專利請求項3所界定（II）之含量範圍；該證據之IIa、IIIb之結構，可對應系爭專利請求項3通式(III)之n=0或1之化合物結構；證據12第14頁第40至41行所示式IVb化合物之結構，亦可對應系爭專利請求項3之通式(V-5)化合物。故證據12與系爭專利請求項3之差異主要仍在於證據12未特定揭露如系爭專利請求項3所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據12亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，因此，同前述理由，應認系爭專利請求項3發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據12不足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

4、證據12不足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

系爭專利請求項4之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，查證據12所揭示IIa、IIIb之結構，可對應系爭專利請求項3通式(III)之n=0或1之化合物結構；證據12說明書所示式VIIa～VIIf化合物的結構可對應於系爭專利請求項4之化合物（VI-b）、（VI-c）、（VI-a）、（VI-d）、（VI-e）；且證據12第14頁第40至41行所示式IVb化合物之結構，可對應系爭專利請求項4之通式(V)化合物(之下位概念化合物(V-5))；惟證據12並未明確揭露其必要成分與任意成分化合物之合計含量須為95質量%以上且100質量%以下之技術內容。故證據12與系爭專利請求項4之差異主要仍在於證據12未特定揭露如系爭專利請求項4所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據12亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，因此，同前述理由，系爭專利請求項4發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前

技術能輕易完成，證據12不足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

5、證據12不足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

系爭專利請求項5之技術特徵及其與系爭專利請求項1技術特徵之差異，業如前述，查證據12說明書第26頁第35至40行所揭示CC-n-Vm化合物、第28頁第【0078】段所揭示實施例M2至M4之CC-3-V1化合物等可對應於系爭專利請求項5之化合物(I-1)、(I-2)、(I-3)；證據12說明書第17頁揭示式VIId化合物可對應系爭專利請求項5之通式(VI-a5)、(VI-a3)、(VI-a4)之化合物。是以證據12與系爭專利請求項5之差異主要仍在於證據12未特定揭露如系爭專利請求項5所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據12亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，因此，同前述理由，系爭專利請求項5發明之整體並非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成，證據12不足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

6、證據12不足以證明系爭專利請求項6至7不具進步性：

系爭專利請求項6係為依附於請求項1或2之附屬項，於解釋系爭專利請求項6之專利權範圍時應包含系爭專利請求項1或2之所有技術特徵。據此，如前開說明，證據12已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，而系爭專利請求項6既依附於請求項1或2，則證據12當然亦不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。又系爭專利請求項7係為依附於請求項1或2之附屬項，於解釋系爭專利請求項7之專利權範圍時應包含請求項1或2之所有技術特徵，故如前所述，證據12已不足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，而系爭專利請求項7既依附於請求項1或2，則證據12當然亦不足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

㈩、證據7或12及證據8至11（擇一)之組合不足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性：

系爭專利請求項1、4至7之技術特徵，均分別說明如前，查證據7或12因未特定揭露如系爭專利請求項1、4至7所界定之成分組合、部分成分含量範圍，且系爭專利請求項1、4至7所界定組成物能達成之功效(如抑制滴加痕與ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)亦非基於證據7或12或通常知識可預期的，故難謂證據7或12足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性之理由，業經本院說明如前；又證據8至11之任一未特定揭露如系爭專利請求項1、4至7所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據8至11之任一亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，故證據8至11任一之技術內容無法補足證據7或12所揭示者與系爭專利請求項1、4至7間之差異，自亦難謂熟習該項技術者基於證據7或12及證據8至11之任一組合能輕易完成如系爭專利請求項1、4至7之發明，因此證據7或12及證據8至11（擇一)之組合當然不足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性。

□、證據7及證據8至12（擇一)之組合不足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

系爭專利請求項3之技術特徵，業如前述，查證據7因未特定揭露如系爭專利請求項3所界定之成分組合、部分成分含量範圍，且系爭專利請求項3所界定組成物能達成之功效(如抑制滴加痕與ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)亦非基於證據7或通常知識可預期的，故難謂證據7足以證明系爭專利請求項3不具進步性之理由，均經本院說明如前，又證據8至12之任一未特定揭露如系爭專利請求項3所界定之成分組合、部分成分含量範圍等技術內容，且證據8至12之任一亦未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，故證據8至12任一之技術內容無法補足證據7所揭示者與系爭專利請求項3間之差異，自亦難謂熟習該項技術者基於證據7及證據8至12之任一組合能輕易完成如系爭專利請求項3之發明，因此證據7及證據8

至12之任一組合當然亦不足證明系爭專利請求項3不具進步性。

□、證據7至12（擇一）及證據13之組合不足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

1、系爭專利請求項8所請「液晶顯示元件」之主要技術特徵為「其使用有申請專利範圍第1至7中任一項之液晶組成物，並具有反向交錯型薄膜電晶體」，於解釋該液晶顯示元件之技術特徵時自會包含使用系爭專利請求項1至7之液晶組成物者。查證據7至12之任一未特定揭露如系爭專利請求項1至7所界定液晶組成物之成分組合、部分成分含量範圍，且該組成物能達成之功效(如抑制滴加痕與ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)亦非基於證據7至12之任一或通常知識可預期的，故證據7至12之任一不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性之理由，與本院前開說明相同。另查證據13雖揭示反向交錯型結構之薄膜電晶體可用於作為例如主動式矩陣LCD(液晶顯示器）之開關裝置，該電晶體包含作為主動層之多晶半導體等技術內容；惟查證據13並未特定揭露如系爭專利請求項1至7所界定液晶組合物之成分組合、含量範圍等技術內容，且證據13亦未揭示同時能達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效之液晶組成物，故證據13之技術內容無法補足證據7至12之任一所揭示者與系爭專利請求項1至7間之差異，自亦難謂熟習該項技術者基於證據7至12之任一與證據13的組合能輕易完成如系爭專利該等請求項之發明，因此證據7至12之任一及證據13的組合亦不足證明系爭專利請求項1至7不具進步性。證據7至12之任一及證據13的組合既不足證明系爭專利請求項1至7不具進步性，則證據7至12之任一及證據13的組合當然亦不足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

2、被告、參加人主張系爭專利請求項8所請為一種液晶顯示元件，其包含請求項1至7中任一項之液晶組成物，並進一步包含反向交錯型薄膜電晶體，查證據13揭示了包含反向交錯型

薄膜電晶體之液晶顯示元件之相關技術內容，且前述證據之組合已足證系爭專利請求項1至7不具進步性，故熟習該項技術者當能輕易完成系爭專利請求項8之發明，故被告之處分並無違法之情事等語，惟查：證據7至12之任一均未揭示其液晶組成物可獲致如系爭專利之發明所欲能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，證據13雖揭示了反向交錯型薄膜電晶體可應用於液晶顯示元件之技術內容，然並未具體敘及其液晶之成分組成，遑論能否同時達成前述功效，是以證據7至12之任一與證據13之組合尚不足以證明系爭專利請求項1至7之任一不具進步性，遑論前開證據之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，從而，被告與參加人前述主張，尚難採憑。

□、證據7至10（擇一）及證據13之組合不足以證明系爭專利請求項9不具進步性：

１、系爭專利請求項9所請「液晶顯示器」之主要技術特徵為「其使用有具備配向膜之申請專利範圍第8項之液晶顯示元件」，於解釋該液晶顯示器之技術特徵時自會包含使用前述請求項8之液晶顯示元件者。查證據7至12之任一及證據13之組合不足證明系爭專利請求項8不具進步性之理由，業如前述，而證據7至12之任一及證據13之組合既不足證明系爭專利請求項8不具進步性，則證據7至10之任一及證據13之組合當然亦不足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

２、被告、參加人主張系爭專利請求項9所請為一種液晶顯示器，其包含請求項8之液晶顯示元件，並進一步包含配向膜，由於前述證據之組合已足證系爭專利請求項8不具進步性，且證據7至10均揭示液晶顯示器包含配向膜，故熟習該項技術者基於前述證據之組合當能輕易完成系爭專利請求項9之發明，被告之處分並無違法之情事等語；惟證據7至12之任一與證據13之組合因未揭示其液晶組成物可獲致如系爭專利之發明所欲能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性(如ODF步驟中穩定液晶材料噴出量等)等功效，尚不足以證明系爭

專利請求項8不具進步性，故自難謂前開證據之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性，是以被告與參加人前述主張，應非可採。

□、對被告主張不採之理由：

被告雖稱證據7至12任一及其組合固未特定揭露如系爭專利上開請求項所界定特定下位概念化合物或其含量，然其等已在不同段落揭示了相當/對應於系爭專利之發明的組成及含量，故熟習該項技術者本可基於證據7至12任一及其組合或其技術內容之組合所揭示的成分、組成，依需求輕易調配而獲致如系爭專利各請求項所界定之特定成分組成、由於證據7至12任一及其組合或其技術內容之組合已揭示相當/對應於系爭專利之發明的組成及含量，在組成相同的之情況下，前述證據揭示者所展現的功效也會與系爭專利之發明相同，故系爭專利之發明功效為熟習該項技術者可預期的等語，惟：

1、按系爭專利核准時專利審查基準第二篇第三章專利要件3.4.2.1發明具有無法預期之功效記載「.....若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期之功效，而其係該發明之技術特徵所導致時，該無法預期之功效得佐證該發明並非能輕易完成。因此，即使申請時之通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者組合、修飾、置換或轉用先前技術所揭露之內容而完成申請專利之發明，但若該先前技術並未揭露組合、修飾、置換或轉用後會產生無法預期之功效時，則申請專利之發明仍非能輕易完成」，因此縱使熟習該項技術者經組合、修飾、置換或轉用先前技術所揭露之內容能完成申請專利之發明，若該發明能達成無法預期之功效，且該功效確係由該發明與先前技術之技術特徵差異而獲致，則該功效得用以佐證該發明之進步性。查證據7至12任一及其組合或其技術內容之組合並未針對如系爭專利之發明所界定的特定成分、含量液晶組成物進行整體且特定之揭露，該等證據主要係在不同段落揭示了相當/對應於系爭專

利之發明的組成及含量，如前所述，熟習該項技術者基於證據7至12任一及其組合所示異向性、熱穩定度等性質雖有可能嘗試調整證據7所示組合物之成分組成，惟由於該等證據並未揭示其組合物能同時達成之抑制滴加痕、製程適合性等功效，且該等功效亦非基於該等證據或系爭專利申請日前之通常知識可推論得知的，故尚難謂熟習該項技術者基於該等證據所揭示者能獲致如系爭專利各請求項發明所界定能達成該等功效的組成物，是以系爭專利各請求項發明之整體應非熟習該項技術者基於前述先前技術能輕易完成。

2、又系爭專利各請求項之發明與證據7至12任一及其組合所揭示者間，至少存在有特定成分、含量之差異，故尚難認彼此之成分組成完全相同，遑論據此而逕謂其等所展現功效亦必然相同；且由系爭專利說明書之實施例、比較例、原告所提補充實驗數據等可知，系爭專利之發明因其特定成分組成可同時達成抑制滴加痕、製程適合性等功效，而查該等功效亦非基於證據7至12任一及其組合或系爭專利申請日前之通常知識可推論得知的，故在被告、參加人未提出反證的情況下(如該功效不足以佐證該發明之進步性等)，尚難否認系爭專利各請求項之發明達成無法預期功效，是以依前述審查基準規定觀之，應認系爭專利各請求項所界定發明非熟悉該項技術者能輕易完成而具有進步性。

□、對參加人主張不採之理由：

參加人主張證據7至12之任一者或其組合已揭露對應於系爭專利請求項1至7之液晶組成物之全部成分及含量範圍，前開證據7至12之任一及其組合縱有未揭露特定下位概念化合物、特定含量數值略有差異之情事，惟該等差異係熟習該項技術者經簡單試驗即可完成，由於系爭專利說明書(如實施例、比較例等)並無提及其液晶組成物係因其特定成分組成之交互作用所達成如抑制滴加痕、製程適合性功效，且原告雖提出補充實驗數據驗證該等功效，然依專利審查基準第二篇第一章1.3.2節「申請日後提出之資料（尤其是實驗數

據）非屬判斷符合可據以實現要件等之基礎」之規定，故尚無須考量該等功效，證據7至12之任一者或其組合足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性、系爭專利請求項1、4雖界定其式(II)化合物含量為3~9.5質量%，惟依系爭專利說明書實施例3至6與8至11所載內容可知，該式(II)化合物即使在11.5質量%(超過9.5質量%)依然展現原告所稱優異滴加痕評價等功效，故在前開證據已揭示對應於該式(II)之化合物且相近之含量範圍(如12~13.5質量%)的情況下，應認該式(II)所示特定化合物及該特定含量範圍未達成無法預期功效，為熟習該項技術者能輕易完成的、關於系爭專利請求項2、5所界定特定化合物(如式(VI-a3)、(VI-a4)、……等)及其等含量範圍之技術特徵並未產生任何特殊功效，以(VI-a4)含量1~6質量%之技術特徵為例，依系爭專利說明書之實施例1及7所示液晶組成物性質可知，即使該式 (VI-a4)化合物之含量高達7.5%(即超過該1~6質量％之含量範圍)，該液晶組成物依展現諸如殘像、滴加痕、製程適合性等評價項目具有良好表現之功效，與此相對，系爭專利說明書實施例12之液晶組成物，雖包含5.0%之式(VI-a4)化合物(符合前述該1~6質量％之含量範圍)，反而展現出較於實例1及7差之評價結果，故在證據7至12之任一者或其組合已揭示涵蓋了該等化合物之通式化合物且相近之含量範圍的情況下，應認系爭專利技術特徵僅係已知成分之含量調整且未產生無法預期功效，為熟習該項技術者能輕易完成的等情形，被告處分未有違法之情事等語，惟參加人上開主張不足採信，理由說明如下：

1、證據7至12之任一者或其組合不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性之理由，業如前述；而查系爭專利說明書段落【0014】至【0015】已具體記載「為了抑制滴加痕之產生，重要的是以特定之混合比例使用特定之化合物，尤其明確了存在難以產生滴加痕之組成物」等情，並輔以具有不同成分組成之複數實施例/比較例等說明其特定組成液晶組成物所達成之抑制滴加痕功效評價，尚難謂有參加人所稱系爭專利

說明書並未提及特定組成交互作用之情事；縱認參加人關於系爭專利說明書等未載明特定組成交互作用之前述主張為真，由於系爭專利說明書之實施例具體載明了複數個能達成前述抑制滴加痕等功效之液晶組成物，且系爭專利更正後各請求項之發明能被其說明書之記載所支持並據以實現亦為兩造及參加人所不爭執，此可由參加人於舉發程序中對更正前請求項提出無法據以實現等爭執，然於本件訴訟中未對更正後請求項再爭執此點可佐，故在參加人未提出證據證明無法確認系爭專利前述更正後請求項之發明達成了抑制滴加痕等功效的情況下，理應認定熟習該項技術者可推論系爭專利請求項1至7之發明基於其等所界定之特定組成液晶組成物等技術特徵達成了前述功效，該等功效自可作為判斷該發明之進步性時需考量的有利功效，與系爭專利說明書是否載明了該功效係由特定組成交互作用而獲致者無涉。

2、依系爭專利說明書、實施例等之記載難謂其更正後請求項之發明無法達成抑制滴加痕等功效，因而於進步性判斷時需考量該等功效之理，業如前述，應與專利權人是否提出補充數據無涉。另查參加人所稱專利審查基準第二篇第一章1.3.2節「申請日後提出之資料(尤其是實驗數據)非屬判斷符合可據以實現要件等之基礎」之部分，主要係該基準用以說明針對是否符合據以實現要件應如何進行申復或補充實驗數據之規定，尚難謂該部分之規定可適用於進步性等專利要件的判斷；況且發明進步性判斷時之有利功效主要應係該發明對照於先前技術所能達之功效差異，而專利權人(申請人)於撰寫說明書階段，本無法預期審查人員於後續審查階段會提出何種先前技術進行如新穎性、進步性等專利要件之論駁，自難苛求專利權人於申請日時即提出其發明對照於任何先前技術所能達成之功效差異，或限制專利權人不得提供補充實驗數據佐證其發明之功效差異，且現行專利審查基準第三章3.4.2.2有利功效係記載「.....有利功效.....為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技

術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者.....」(參該基準第2-3-24頁)，而查專利權人於舉發階段所提補充數據，主要係關於符合其請求項所界定特定組成者能達成前述抑制滴加痕等功效之實施例、追加實驗例等數據，在系爭專利已載明可達成該等功效之特定實施例且參加人未能提出反證之情況下，尚難謂該等補充數據所示功效非屬自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，該有利功效自得作為判斷系爭專利具有進步性之依據。

3、查系爭專利之發明所達成前述功效是否係熟習該項技術者無法預期的，其對照判斷之基礎為先前技術與通常知識(而非系爭專利說明書之實施例等)，故在參加人未能舉證證明該等功效或系爭專利說明書前述相關記載，係熟習該項技術者基於前述先前技術或通常知識而可推論得知之前提下，自難謂該式(II)所示特定化合物及該特定含量範圍所達成功效係熟習該項技術者基於該等證據(即先前技術)所揭示之技術內容而能預期的，遑論逕認該發明不具有進步性；縱認參加人所稱「系爭專利請求項1、4雖界定其式(II)化合物含量為3~9.5質量%，惟依系爭專利說明書實施例.....該式(II)化合物即使.....超過9.5質量%.....依然展現.....優異滴加痕評價等功效」為真，其至多僅能說明「式(II)化合物含量為3~9.5質量%」相較於「式(II)化合物含量為11.5質量%」者不足以顯出功效之增進，尚難據此而認定該「式(II)化合物含量為3~9.5質量%」所達成功效對照於先前技術(或通常知識)已習知者為可預期的，況查系爭專利前述請求項所界定者除該「式(II)化合物含量為3~9.5質量%」外，尚包含特定含量範圍之式(I)、(IIIa)、(IIIb-1)化合物等其他技術特徵，系爭專利之前述功效亦可能係由該等其他技術特徵對照於先前技術產生之差異而導致的，亦難僅因該「式(II)化合物含量為3~9.5質量%」相較於其含量為11.5質量%者未顯現功效增進，而認定系爭專利該請求項之發明所達成之前述

功效係熟習該項技術者(基於先前技術所)能預期的，遑論逕認該發明不具有進步性。同理，縱認參加人上開「關於系爭專利請求項2、5所界定特定化合物(如式(VI-a3)、(VI-a4)、.....等)及其等含量範圍之技術特徵.....依系爭專利說明書.....實施例12之液晶組成物，雖包含5.0%之式(VI-a4)化合物(符合前述該1至6質量%之含量範圍)，反而展現出較於實例1及7差之評價結果」為真，由於參加人並未舉證說明該等功效係熟習該項技術者基於前述先前技術或通常知識而可預期的，且系爭專利前述請求項所界定發明尚包含其他技術特徵，尚難僅基於系爭專利說明書某些特定實施例/比較例之記載而認定該等發明之功效係基於先前技術、通常知識可預期得到的，遑論逕謂該等發明不具有進步性。

4、又專利審查基準第二篇第一章2.4.1.7明文規定：「物之技術特徵應以結構予以界定，若無法以結構清楚界定時，始得以功能、特性、製法或用途予以界定。」(參該基準第2-1-29頁)，而查系爭專利所申請之標的主要為液晶組成物，其請求項的內容係屬於物之技術特徵，故系爭專利更正前後之請求項中以其組成成分之化合物結構、含量範圍等方式界定其所請組成物，難謂有不符專利相關法規之情事；且如前述，熟習該項技術者基於系爭專利說明書如實施例/比較例等記載已可理解更正後請求項所界定之特定成分組成等技術特徵達成了如抑制滴加痕等功效，足見參加人所稱交互作用或其功效對系爭專利所請液晶組成物實質上並未產生除了該等特定成分組成技術特徵以外之額外限定條件，自當無將該交互作用或其功效贅敘於系爭專利請求項之必要，相對於此，若苛求更正後之請求項須記載前述交互作用或其功效等技術特徵，反會因冗贅敘述實質相同之技術特徵而有導致不符專利法第26條第2項關於請求項應以簡潔方式記載相關規定之疑慮。再者，系爭專利說明書之記載所強調者雖主要為含有式(I)、(II)、(IIIb-1)所示化合物的液晶組成物可達成抑制滴加痕等功效之記述內容，然系爭專利說明書並未包含如具

有系爭專利更正後請求項所界定之含有其他成分的液晶組成物無法達成前述功效之記載，且如前述，經比對系爭專利說明書複數實施例/比較例等所示組成物後，熟習該項技術者可理解具有如更正後請求項所界定之發明包含前述能達成該等功效之實施例且未包含無法達成者(如比較例所示之組成物)，因而不會推論系爭專利請求項1至9所界定液晶組成物（包含該式(I)、(II)、(IIIb-1)所示化合物與如式(IIIa)之其他特定化合物等成分者）無法達成抑制滴加痕等功效，故熟習該項技術者基於系爭專利說明書、實施例等之記載，至多僅會得出未含有式(I)、(II)、(IIIb-1)所示化合物之液晶組成物無法達成抑制滴加痕功效之結論，尚難謂必然能得出只要含有該式(I)、(II)、(IIIb-1)所示化合物者就能達成該等功效之推論，遑論據此而逕認更正後請求項之發明所界定其他化合物並非必要成分或逕認該發明不具進步性。另關於原告所提補充數據之部分，如前所述，該等數據主要係關於其組成物可達成抑制滴加痕等由該系爭專利申請時說明書之記載可推論得知的功效，難謂為新功效而不適於用以佐證更正後請求項所界定發明之進步性；況如前述，熟習該項技術者基於系爭專利說明書如實施例/比較例等記載已可理解更正後請求項之發明可達成如抑制滴加痕等功效，故在參加人未提出證據證明該發明無法達成抑制滴加痕功效之情況下，縱不考量該補充數據所示者，亦無礙於抑制滴加痕之功效適用於佐證系爭專利具有進步性之認定。

5、至於參加人稱原告雖提出之多次更正中而對於達成系爭專利發明目的之必要技術特徵立場有所改變乙節，惟查，更正之目的本在於讓專利權人可藉由更正消除說明書、申請專利範圍及圖式中的疏失、缺漏，或限縮申請專利範圍以避免構成專利權被撤銷之理由，故專利權人本可針對前一次更正版本內容不足或疏漏之處，提起另一更正版本以正確界定其請求項之發明的技術特徵，供專利專責機關判斷是否應准予更正，自難僅因多次更正版本間對請求項技術特徵之界定有異

而認定最終准予更正之內容必然不能為系爭專利說明書所支持；況查更正後請求項之內容能否為其說明書所支持應屬專利法第26條第1項規定之另一專利要件，其判斷方式與進步性要件所注重者並不相同，尚難將二者之判斷逕互援用，且於本件準備程序之爭點整理中，參加人未針對該支持要件提出爭執，故亦難以未經該支持要件列為爭點且充分攻防的情況下，逕於本件進步性之判斷中連帶考量系爭專利更正後之內容能否為說明書所支持等事項，末此敘明。

七、綜上所述，證據7不足以證明系爭專利請求項1至2、4至7不具進步性；證據8不足以證明系爭專利請求項1、3、6不具進步性；證據9不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性；證據10不足以證明系爭專利請求項1至4、6至7不具進步性；證據11不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性；證據12不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性；證據7或12及證據8至11（擇一）之組合不足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性；證據7 及證據8至12（擇一）之組合不足以證明系爭專利請求項3不具進步性；證據7至12（擇一）及證據13之組合不足以證明系爭專利請求項8不具進步性；證據7至10（擇一）及證據13之組合不足以證明系爭專利請求項9不具進步性，是以原處分認為上開證據及其證據組合可分別證明系爭專利請求項1至9不具進步性，而為「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分，尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤。從而，原告訴請撤銷原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定，為有理由，應予准許。

八、本件判決基礎已經明確，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，認均不足以影響判決結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

九、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　9　　月　　14　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　林怡伸

法　官　林惠君

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
一符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
二非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

	4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合一、二之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出二所示關係之釋明文書影本及委任書。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　9　　月　　20　　日

書記官　張玫玲

附表（舉發引證）：

證據	內容	所在頁碼
證據7 (乙證1-6)	西元2013年3月14日公開之美國第2013/0062560A1號「Liquid crystal composition and liquid crystal display device」專利申請案	乙證1卷第270頁
證據8 (乙證1-5)	西元2008年8月14日公開之美國第2008/0193681A1號「Liquid-Crystal Medium」專利申請案	乙證1卷第259頁
證據9 (乙證1-4)	西元2012年11月16日公開之我國第201245426A1號「液晶介質」專利申請案	乙證1卷第244頁
證據10 (乙證1-3)	西元2012年10月25日公開之美國2012/0268706A1號「Compounds and liquid-crystalline medium」專利申請案	乙證1卷第143頁
證據11 (乙證1-2)	西元2013年3月16日公開之我國第201311870A1號「液晶介質」專利申請案	乙證1卷第115頁
證據12	西元2008年2月20日公開之歐洲第1	乙證1卷第20頁

(乙證1-1)	889894A1「Liquid crystalline medium」號專利申請案	背面
證據13 (乙證3-3)	西元1994年5月10日公告之美國第5311041號「Thin film transistor having an inverted stagger type structure」專利	乙證3卷第48頁
註:系爭專利申請日為西元2013年3月26日		